



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2011-0076376
(43) 공개일자 2011년07월06일

(51) Int. Cl.

C09K 11/06 (2006.01) H01L 51/50 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2009-0133071

(22) 출원일자 2009년12월29일

심사청구일자 2009년12월29일

(71) 출원인

에스에프씨 주식회사

충청북도 청원군 오창면 각리 641-5

(72) 발명자

제종태

충북 청주시 상당구 용암동 건영아파트 106동 801호

정성욱

경상남도 진주시 주악동 금호석류마을아파트 104동 402호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

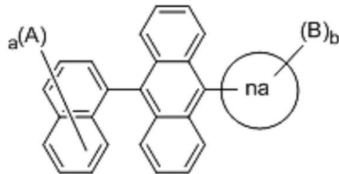
특허법인충현

전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 호스트 화합물 및 이를 이용한 유기전계발광소자

(57) 요약

본 발명은 하기 화학식 (1)로 표현되는 호스트 화합물 및 이를 포함하는 유기전계발광소자에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 호스트 화합물을 포함하는 유기전계발광소자는 청색 또는 녹색 영역에서 휘도, 색순도 및 수명 특성이 우수한 효과가 있다.



(1)

(상기 식에서, A, B, a, b 및 na는 발명의 상세한 설명 및 청구범위에 정의된 바와 같다)

대표도 - 도1

80
70
60
50
40
30
20
10

(72) 발명자

김성훈

전라북도 전주시 완산구 효자동1가 대림아파트 10
2동 102호

이세진

대전광역시 동구 자양동 86-13번지

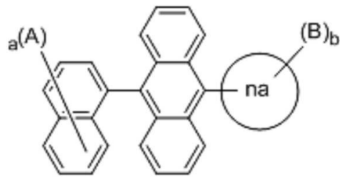
이상해

대전 유성구 반석동 613 반석마을아파트 603동
1002호

특허청구의 범위

청구항 1

하기 화학식 (1)로 표시되는 호스트 화합물:



(1)

(상기 식에서,

na는 나프탈렌기이며, A 및 B는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 치환 또는 비치환된 탄소수 1-20의 알킬기, 치환 또는 비치환의 탄소수 6 내지 40의 아릴기, 치환 또는 비치환의 탄소수 3 내지 20의 헤테로 아릴기, 게르마늄기, 보론기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 24의 알킬실릴기, 및 치환 또는 비치환의 탄소수 6-40의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 것이 바람직하며,

a는 0 내지 7의 정수이고, b는 1 내지 7의 정수이며, a 및 b가 2 이상의 경우 복수의 A 및 B는 각각 독립적으로 동일 또는 상이하다)

청구항 2

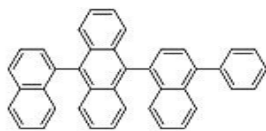
제1항에 있어서,

상기 A 및 B의 치환기는 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 24의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 24의 시클로알킬기, 할로겐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 24의 아릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 24의 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 24의 헤테로아릴기, 게르마늄기, 보론기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 24의 알킬실릴기, 치환 또는 비치환의 탄소수 6-40의 아릴실릴기 및 중수소로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 호스트 화합물.

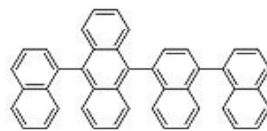
청구항 3

제1항에 있어서,

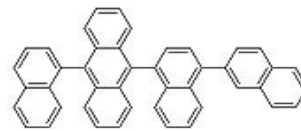
하기 화학식 (H1) 내지 화학식 (H7)으로 표시되는 군으로부터 선택된 어느 하나의 화합물인 것을 특징으로 하는 호스트 화합물:



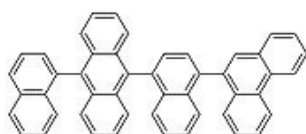
(H1)



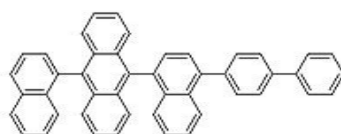
(H2)



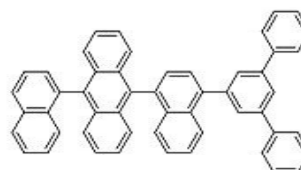
(H3)



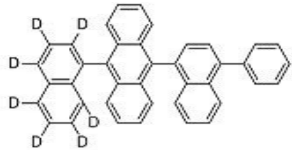
(H4)



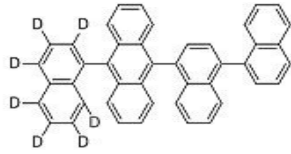
(H5)



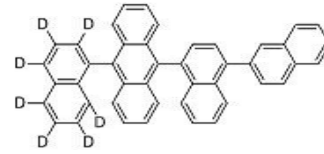
(H6)



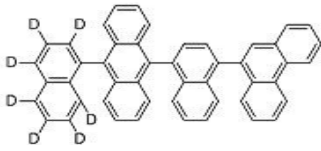
(H7)



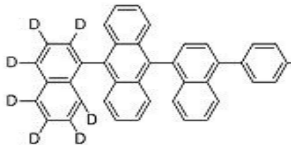
(H8)



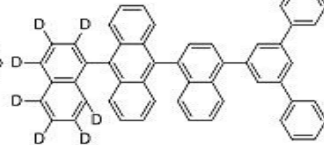
(H9)



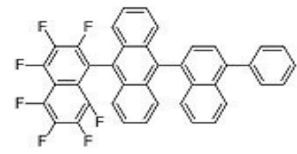
(H10)



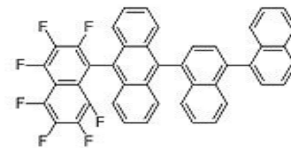
(H11)



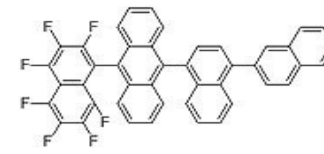
(H12)



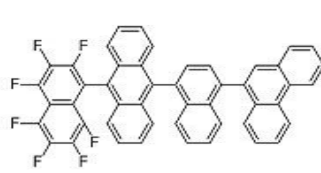
(H13)



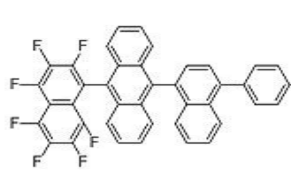
(H14)



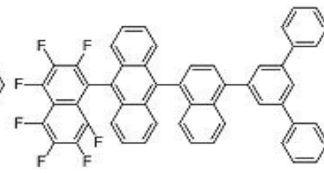
(H15)



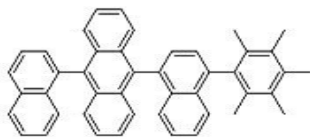
(H16)



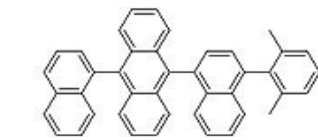
(H17)



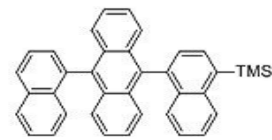
(H18)



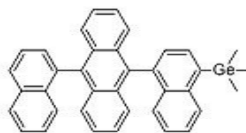
(H19)



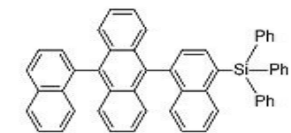
(H20)



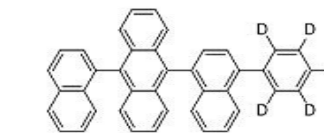
(H21)



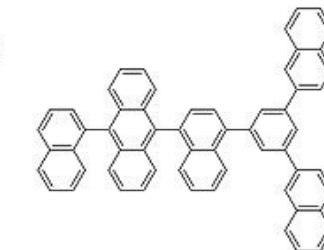
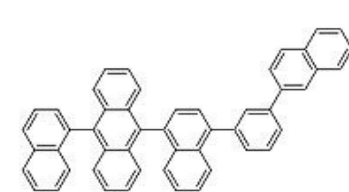
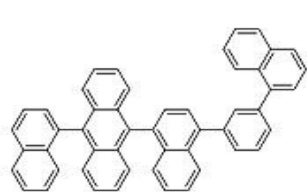
(H22)



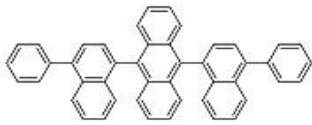
(H23)



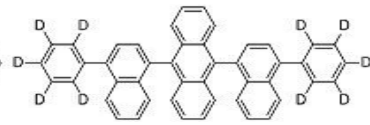
(H24)



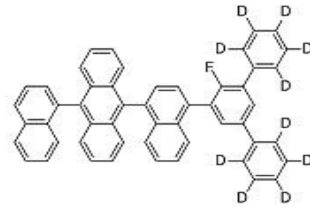
(H25)



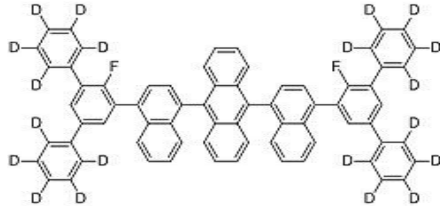
(H26)



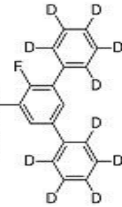
(H27)



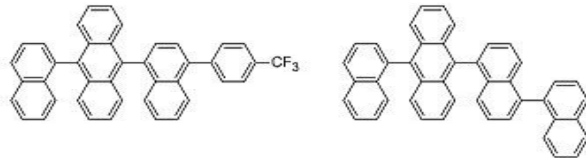
(H28)



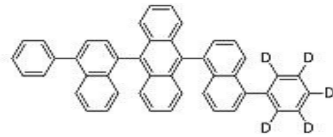
(H29)



(H30)



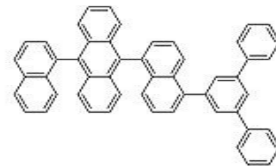
(H31)



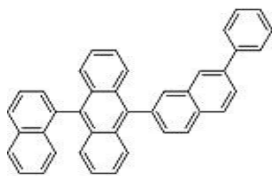
(H32)



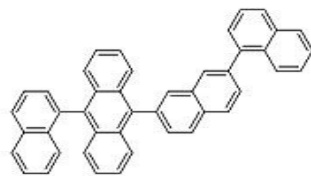
(H33)



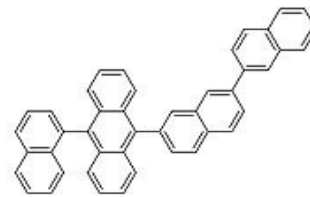
(H34)



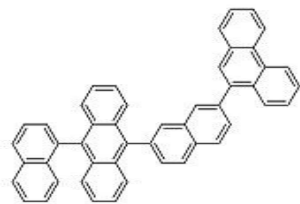
(H35)



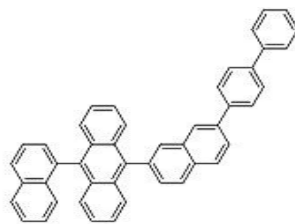
(H36)



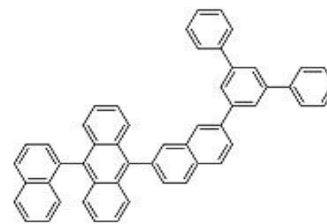
(H37)



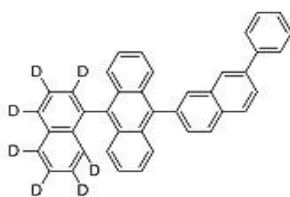
(H38)



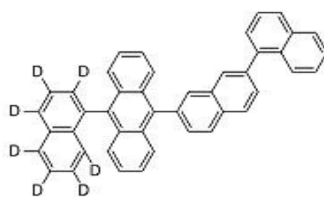
(H39)



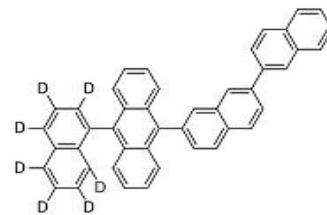
(H40)



(H41)



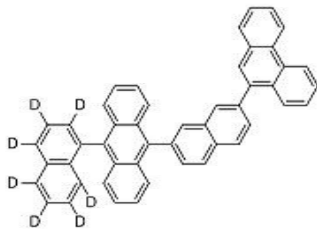
(H42)



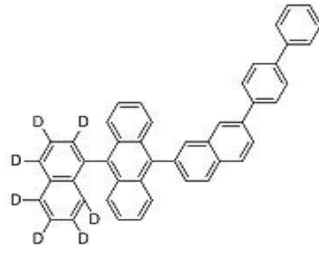
(H43)

(H44)

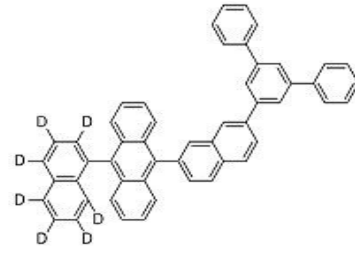
(H45)



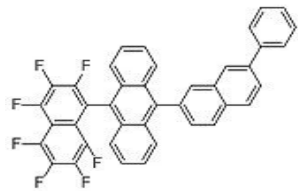
(H46)



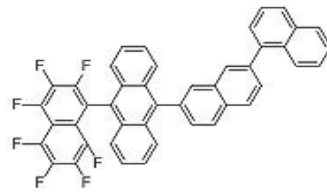
(H47)



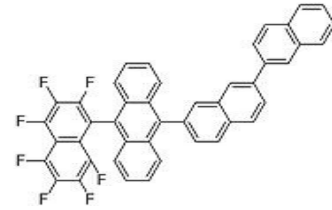
(H48)



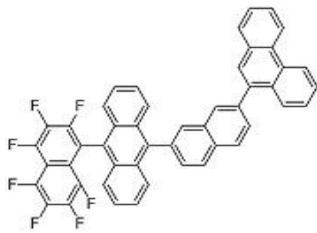
(H49)



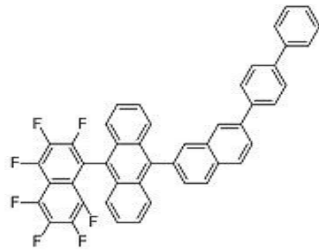
(H50)



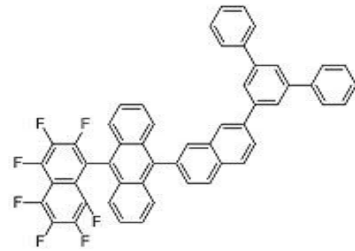
(H51)



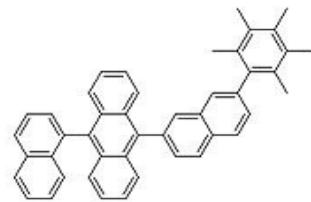
(H52)



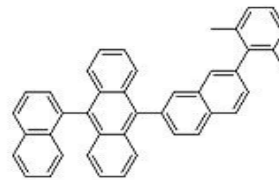
(H53)



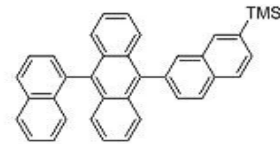
(H54)



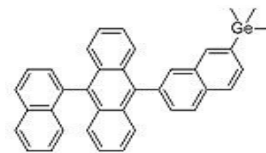
(H55)



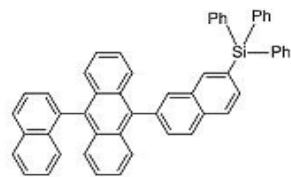
(H56)



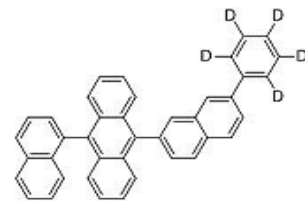
(H57)



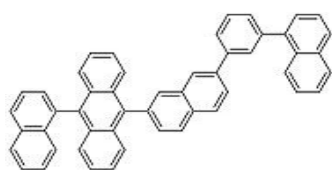
(H58)



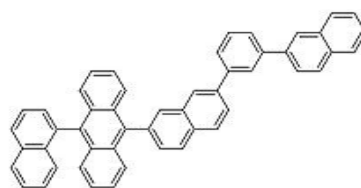
(H59)



(H60)



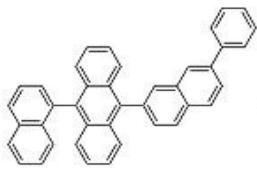
(H61)



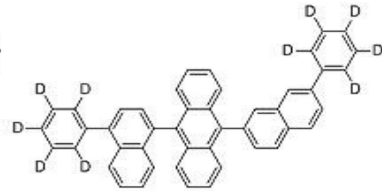
(H62)



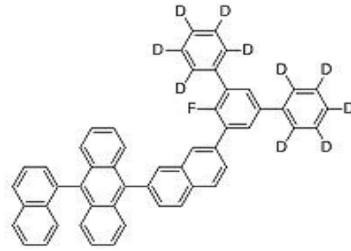
(H63)



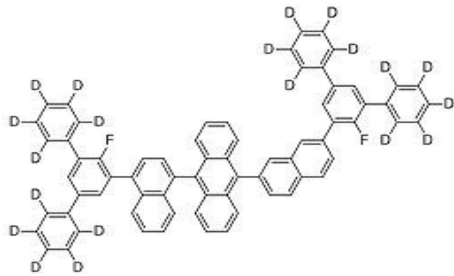
(H64)



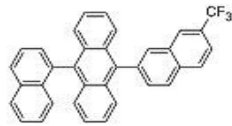
(H65)



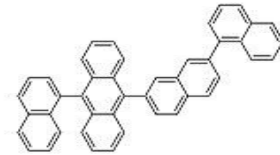
(H66)



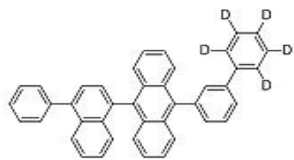
(H67)



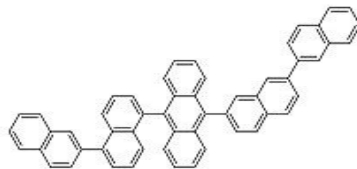
(H68)



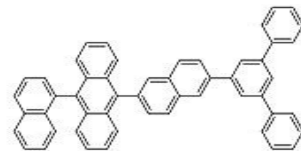
(H69)



(H70)



(H71)



(H72)

청구항 4

애노드;

캐소드; 및

상기 애노드와 캐소드 사이에 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 따른 호스트 화합물이 함유된 층을 포함하는 유기전계발광소자.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 화합물이 함유된 층은 상기 애노드 및 캐소드 사이의 발광층인 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 애노드와 캐소드 사이에 정공주입층, 정공수송층, 전자저지층, 정공저지층, 전자수송층 및 전자주입층으로 이루어진 균으로부터 선택된 하나 이상의 층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

청구항 7

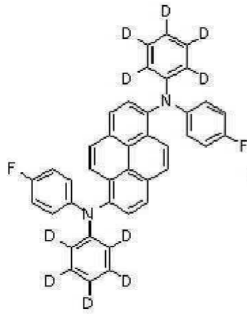
제6항에 있어서,

상기 정공주입층, 정공수송층, 전자저지층, 발광층, 정공저지층 전자수송층 및 전자주입층 중 적어도 한층 이상이 용액공정에 의하여 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

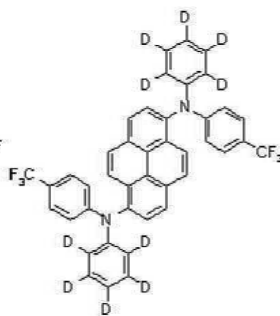
청구항 8

제4항에 있어서,

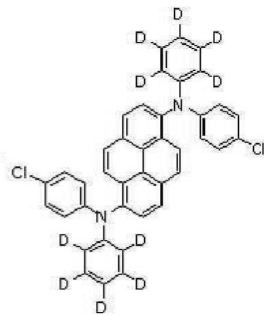
상기 발광층은 하기 화학식 BD1 내지 BD68의 화합물 중 어느 하나 이상의 화합물을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.



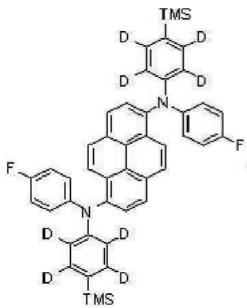
BD 1



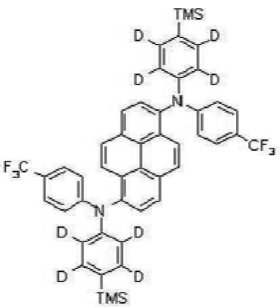
BD 2



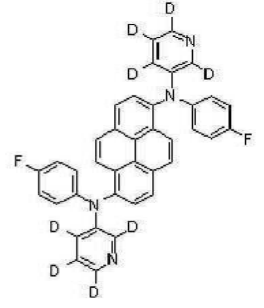
BD 3



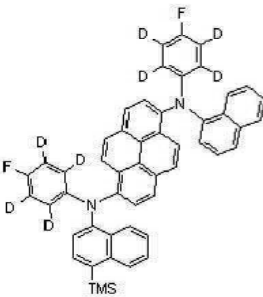
BD 4



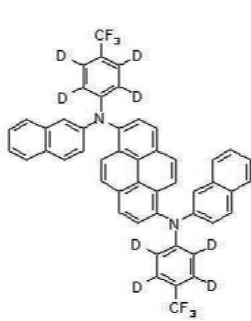
BD 5



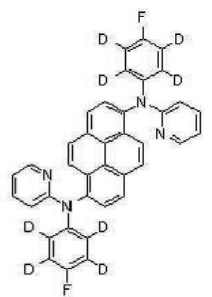
BD 6



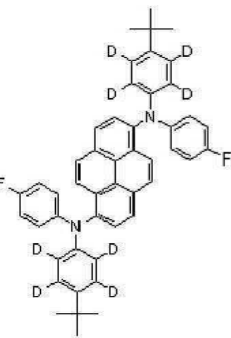
BD 7



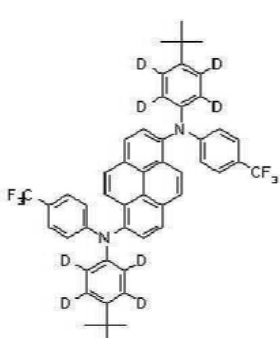
BD 8



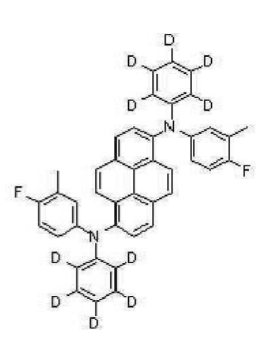
BD 9



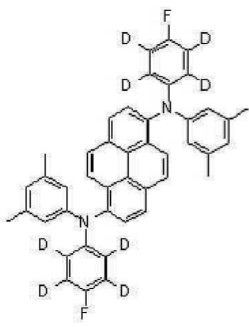
BD 10



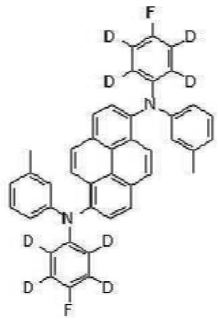
BD 11



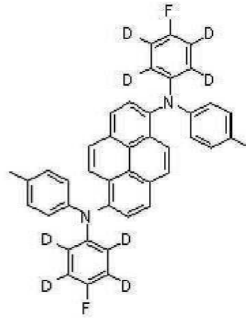
BD 12



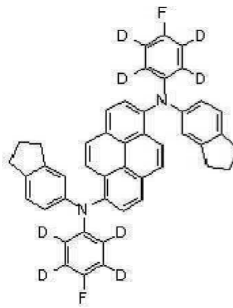
BD 13



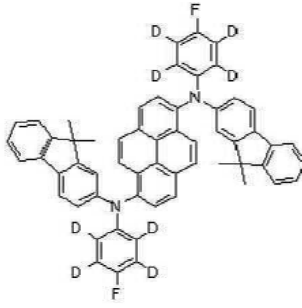
BD 14



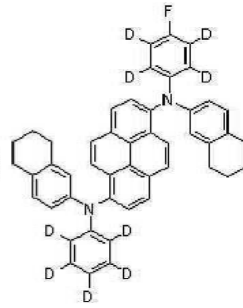
BD 15



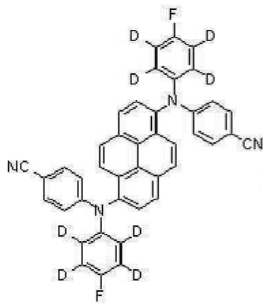
BD 16



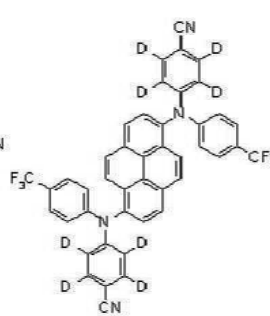
BD 17



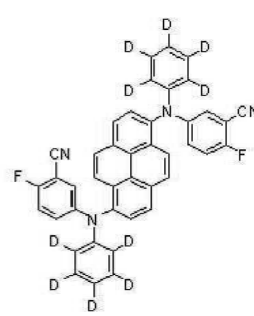
BD 18



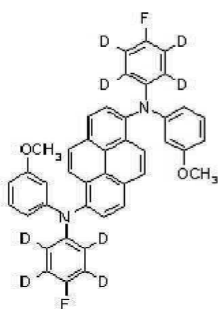
BD 19



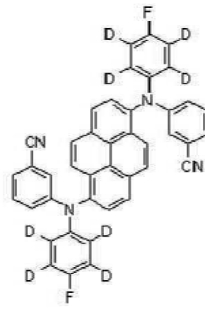
BD 20



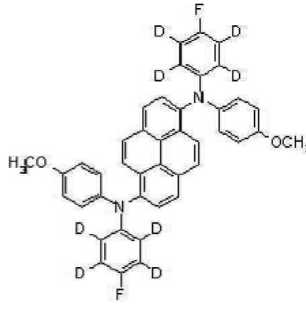
BD 21



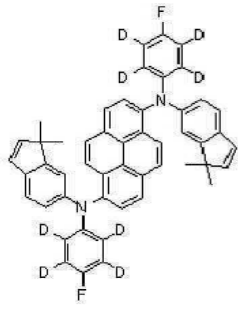
BD 22



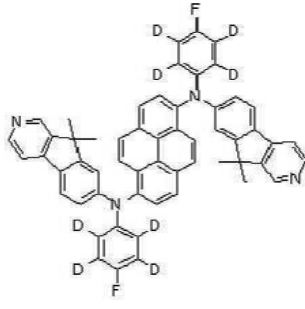
BD 23



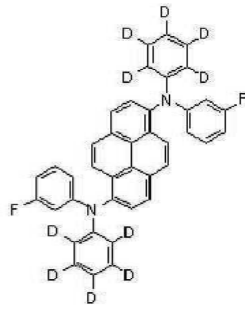
BD 24



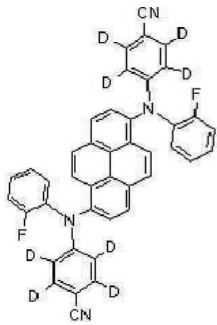
BD 2 5



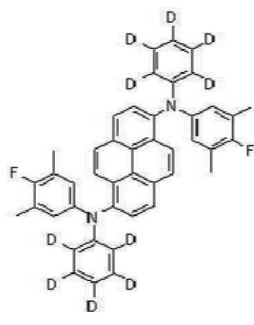
BD 2 6



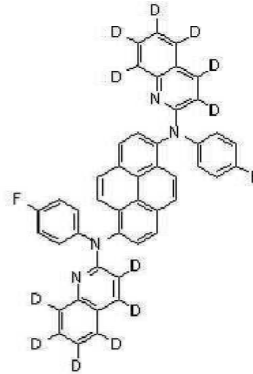
BD 2 7



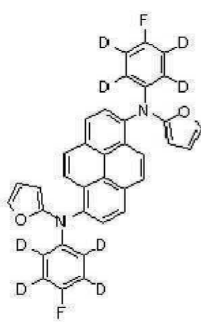
BD 2 8



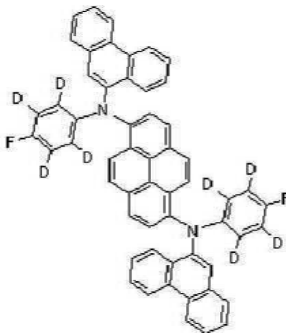
BD 2 9



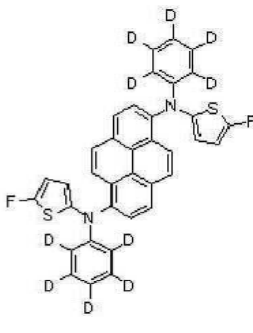
BD 3 0



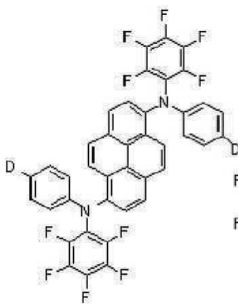
BD 3 1



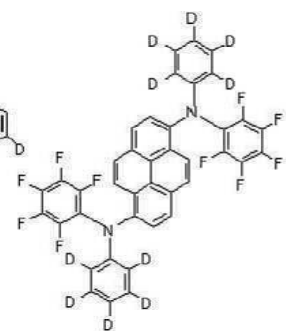
BD 3 2



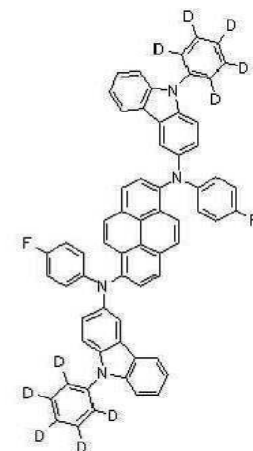
BD 3 3



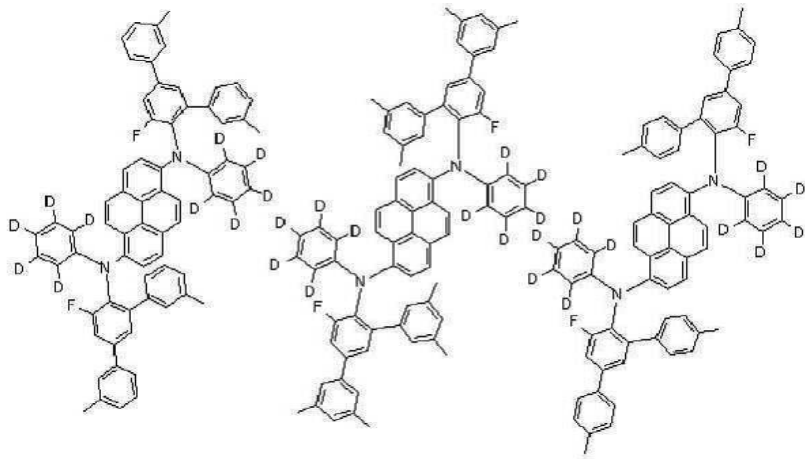
BD 3 4



BD 3 5



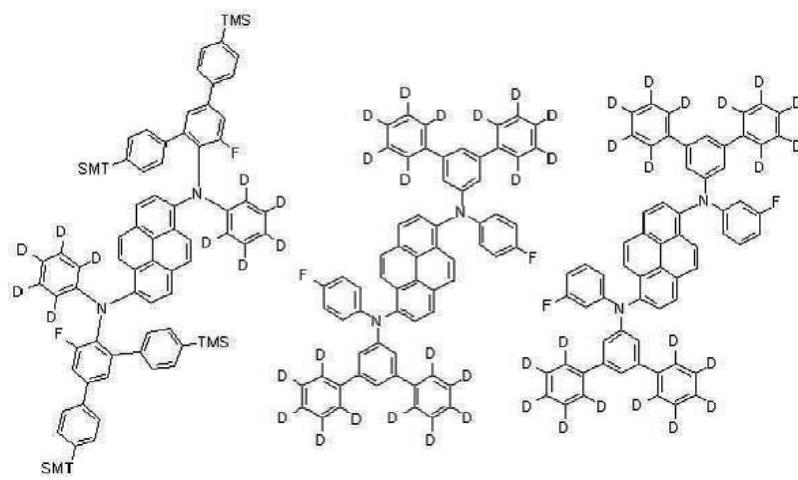
BD 3 6



BD 37

BD 38

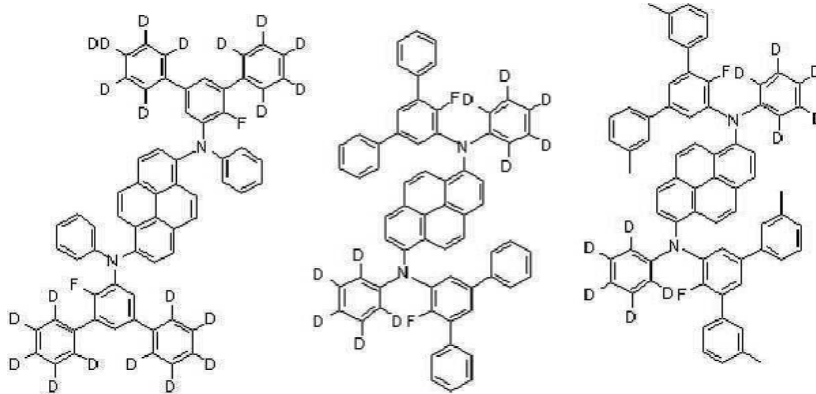
BD 39



BD 40

BD 41

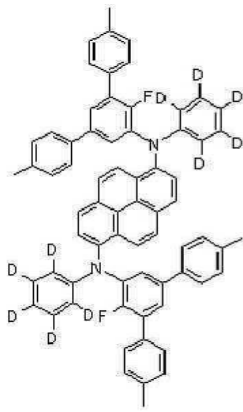
BD 42



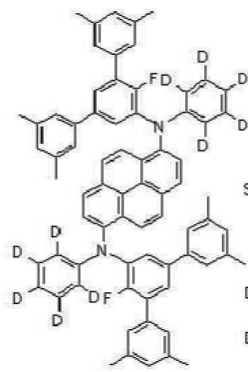
BD 43

BD 44

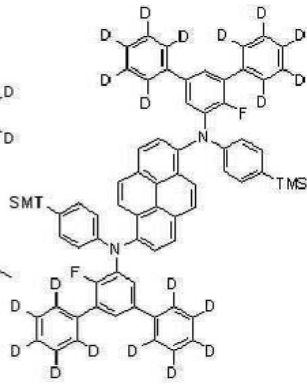
BD 45



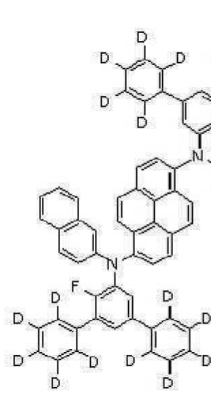
BD 4 6



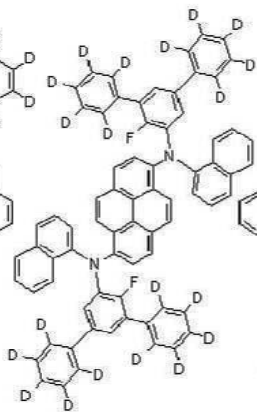
BD 4 7



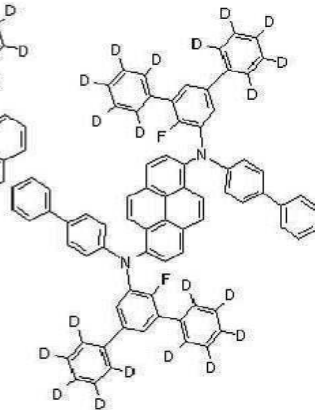
BD 4 8



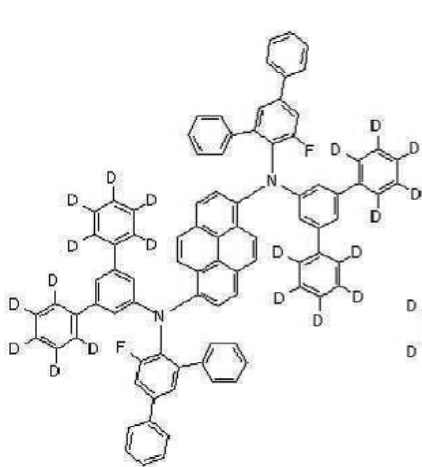
BD 4 9



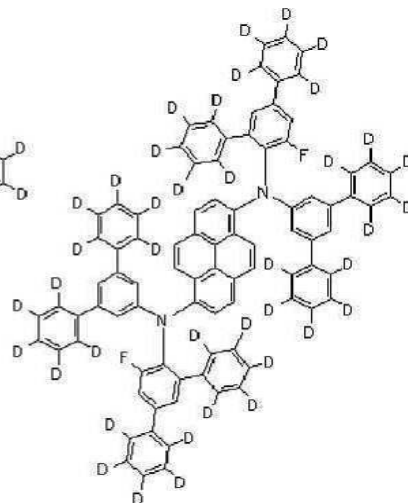
BD 5 0



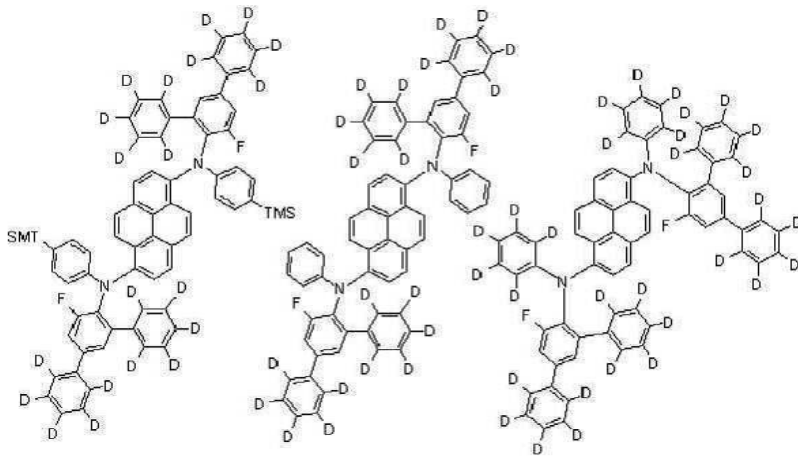
BD 5 1



BD 5 2



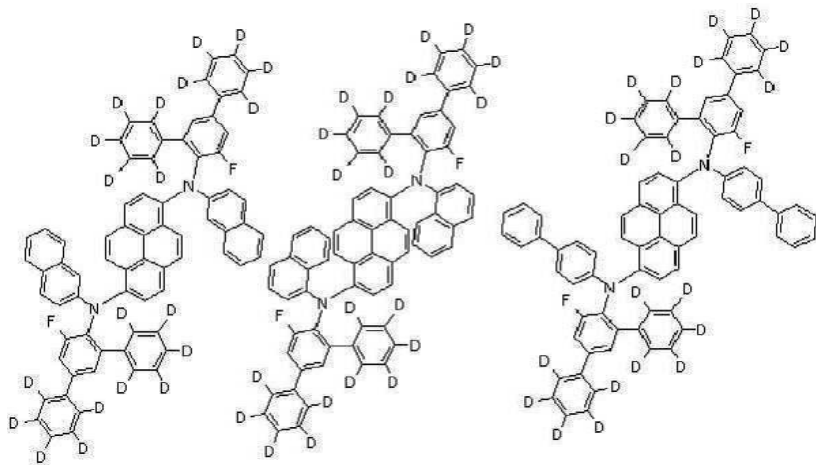
BD 5 3



BD 5 4

BD 5 5

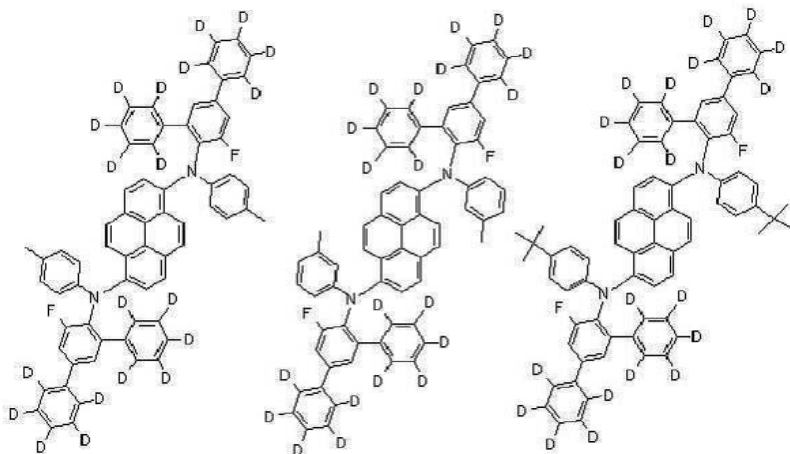
BD 5 6



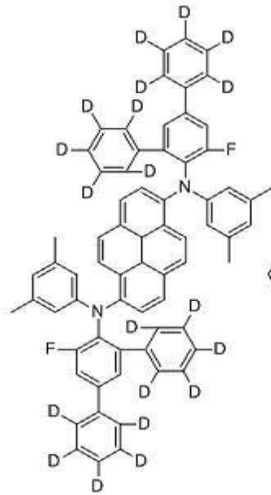
BD 5 7

BD 5 8

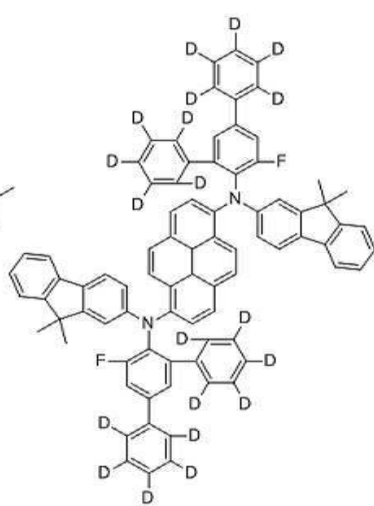
BD 5 9



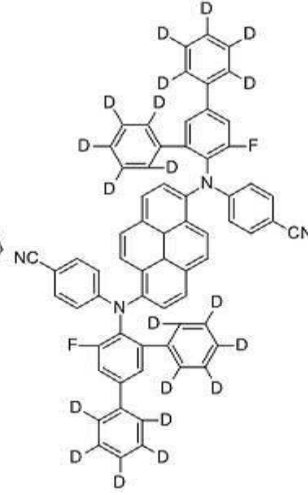
BD 6 0



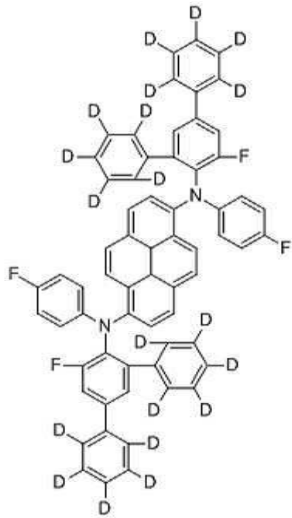
BD 6 1



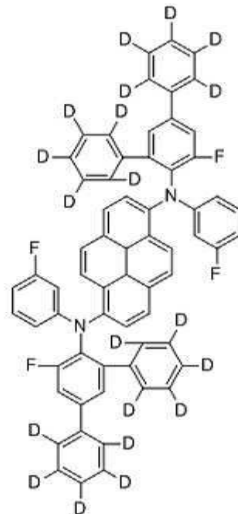
BD 6 2



BD63



BD64



BD65



BD66

청구항 9

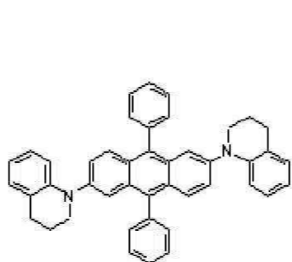
제4항에 있어서,

상기 발광층은 하기 화학식 GD1 내지 GD6의 화합물 중 어느 하나 이상의 화합물을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

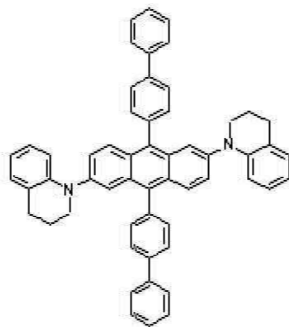
BD67



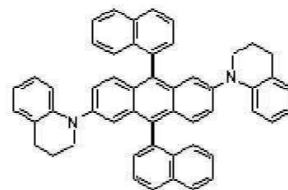
BD68



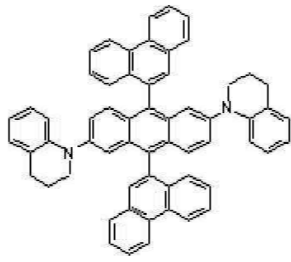
GD1



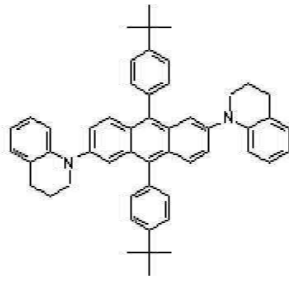
GD2



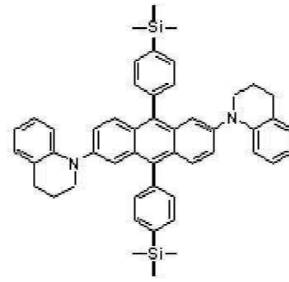
GD3



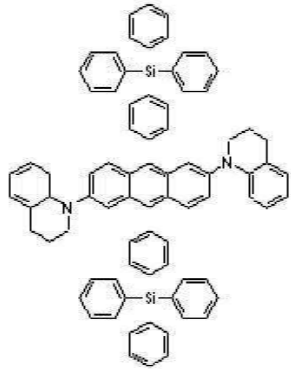
GD4



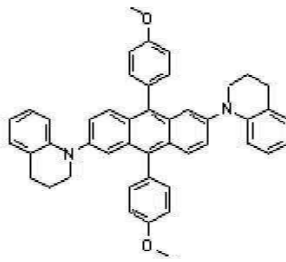
GD5



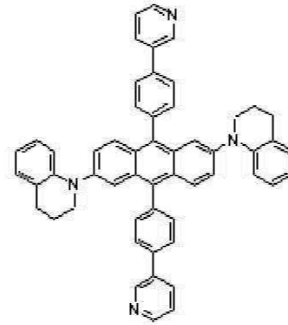
GD6



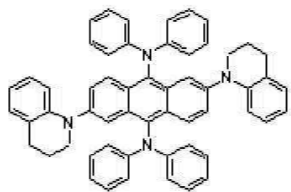
GD7



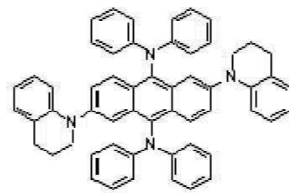
GD8



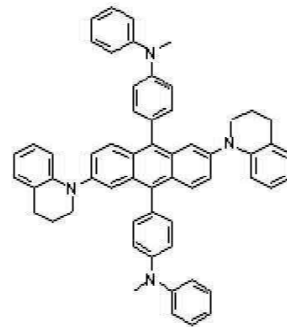
GD9



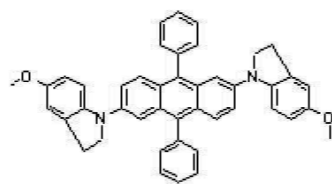
GD10



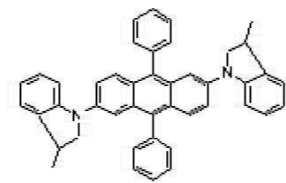
GD11



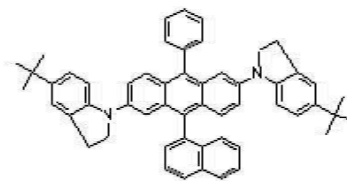
GD12



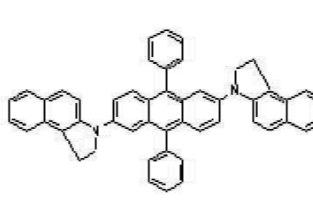
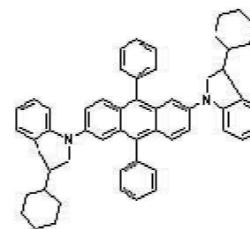
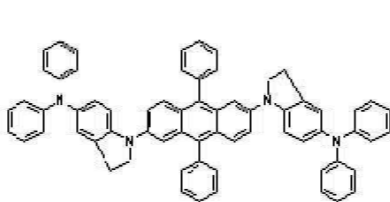
GD13



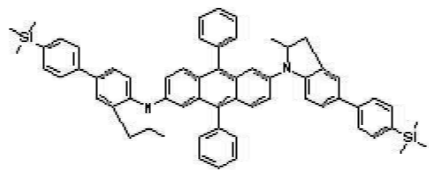
GD14



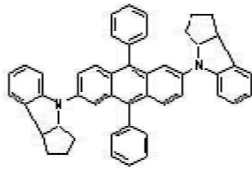
GD15



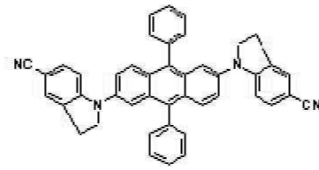
GD16



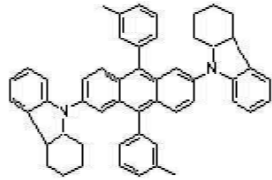
GD17



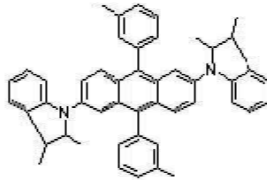
GD18



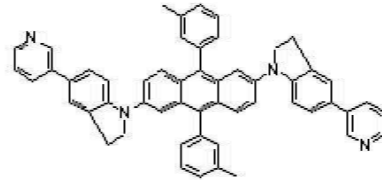
GD19



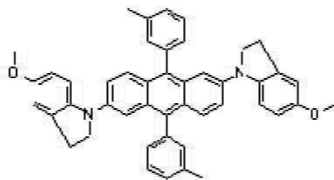
GD20



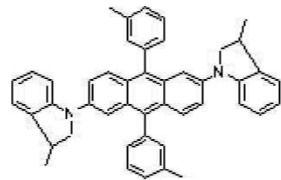
GD21



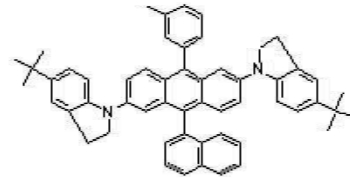
GD22



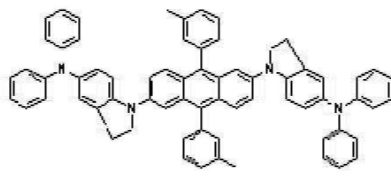
GD23



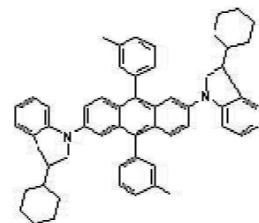
GD24



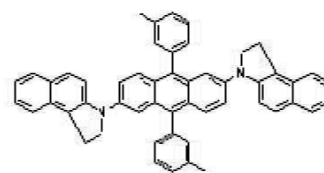
GD25



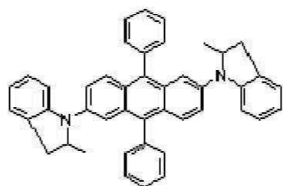
GD26



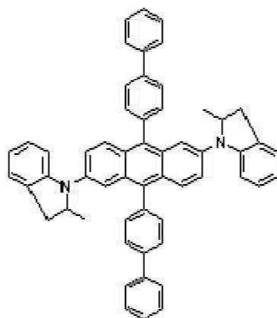
GD27



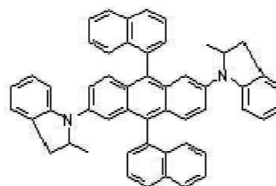
GD28



GD29



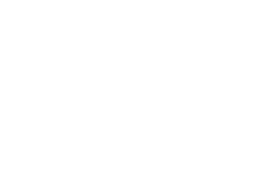
GD30



GD31

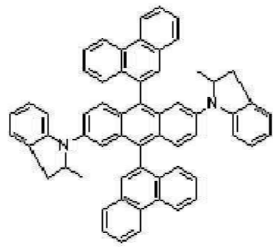


GD32

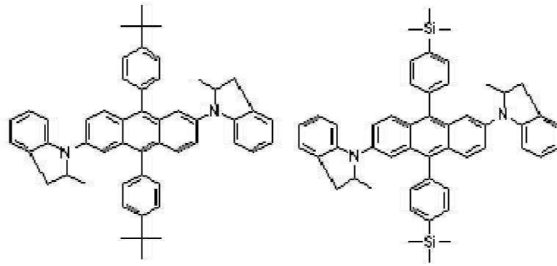


GD33



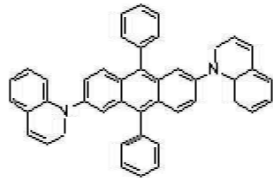


GD34

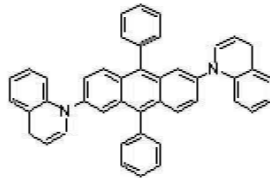


GD35

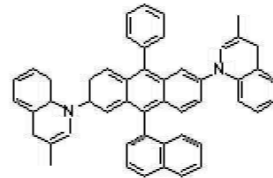
GD36



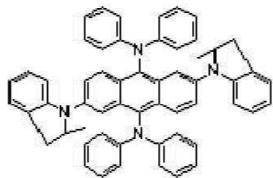
GD37



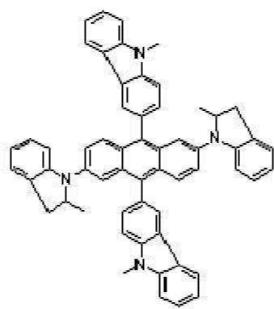
GD38



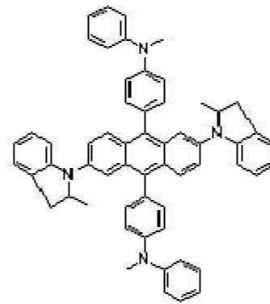
GD39



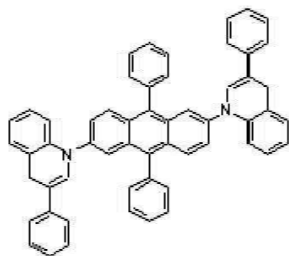
GD40



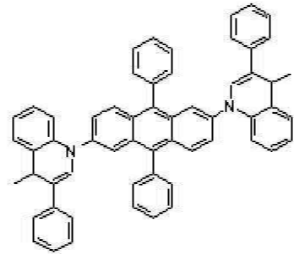
GD41



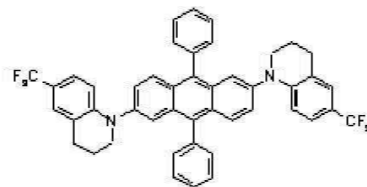
GD42



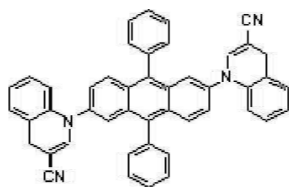
GD43



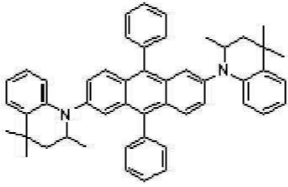
GD44



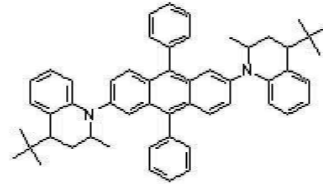
GD45



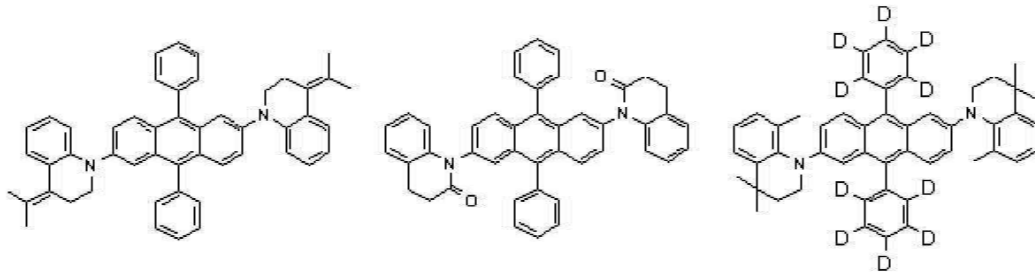
GD46



GD47



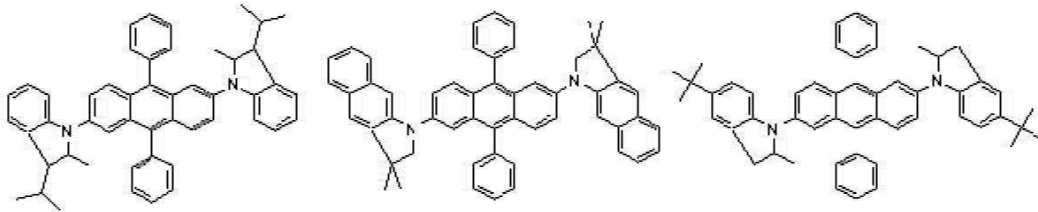
GD48



GD49

GD50

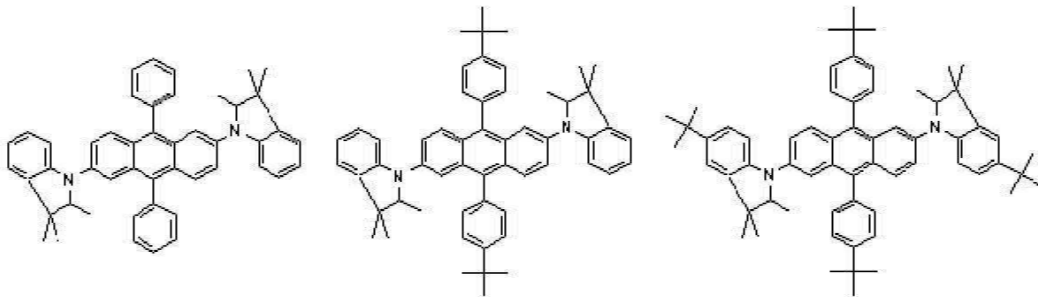
GD51



GD52

GD53

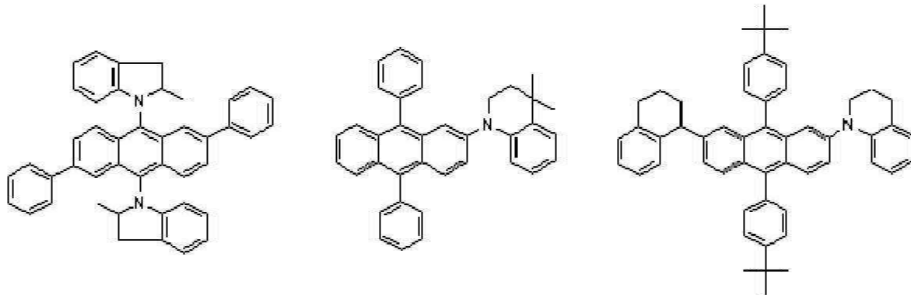
GD54



GD55

GD56

GD57



GD58

GD59

GD60

청구항 10

제4항에 있어서,

표시소자, 디스플레이 소자 및 단색 또는 백색 조명용 소자에 사용되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

명세서

발명의 상세한 설명

기술분야

본 발명은 호스트 화합물 및 이를 이용한 유기전계발광소자에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 휘도, 색순도 및 수명 특성이 우수한 청색 또는 녹색 호스트 화합물 및 이를 이용한 유기전계발광소자에 관한 것이다.

[0001]

배경 기술

[0002] 최근 표시장치의 대형화에 따라 공간 점유가 작은 평면표시소자의 요구가 증대되고 있는데, 대표적인 평면표시소자인 액정 디스플레이는 기존의 CRT에 비해 경량화가 가능하다는 장점은 있으나, 시야각(viewing angle)이 제한되고 배면 광(back light)이 반드시 필요하다는 등의 단점을 갖고 있다. 이에 반하여, 새로운 평면표시소자인 유기전계발광소자(organic light emitting diode:OLED)는 자기 발광 현상을 이용한 디스플레이로서, 시야각이 크고, 액정 디스플레이에 비해 경박, 단소해질 수 있으며, 빠른 응답 속도 등의 장점을 가지고 있으며, 최근에는 풀-컬러(full-color) 디스플레이 또는 조명으로의 응용이 기대되고 있다. 이를 위하여 고효도, 고효율, 고색 온도 및 장수명의 발광물질에 대한 필요성이 증가하고 있다.

[0003] 대표적 유기전계발광소자는 1969년 구르니(Gurnee)에 의해서 공지(US 3,172,862, US 3,173,050)된 이래로 고성능상의 한계로 인하여 다양한 용도에서의 사용이 제한되어 왔으나, 1987년 이스트만 코닥사(Eastman Kodak c o.)의 다층 구조의 유기전계발광소자 발표(C.W. Tang et al., Appl. Phys. Lett ., 51, 913(1987); J. Applide Phys., 65, 3610(1989)) 이후 기존의 문제점을 극복하면서 빠른 속도로 발전하여 왔다. 유기전계발광소자에 대한 많은 연구가 이루어지고 있지만, 현재까지는 요구되는 휘도, 구동 안정성 및 수명 등의 특성을 충분히 만족시키지 못하고 있는 실정이며, 따라서 이를 해결하기 위한 다양한 기술개발이 시급한 실정이다. 이스트만코닥사의 2000년 한국공개특허공보(특2000-0048009호)에는 다양한 안트라센 유도체가 유기전계소자의 홀전달층에 사용된 예는 있으나, 호스트(host)에 도펀트(dopant)를 도핑하는 에너지 이동 원리를 기본으로 하는 호스트-게스트 시스템에 있어서, 청색 및 녹색 발광층 호스트 물질로서 새로운 화합물에 대한 많은 연구가 필요한 상황이다.

발명의 내용

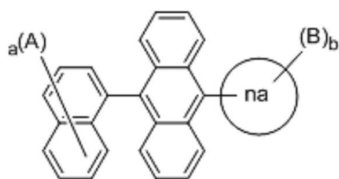
해결 하고자하는 과제

[0004] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 휘도, 색온도 및 장수명 특성의 우수한 청색 또는 녹색 호스트 화합물을 제공하는 것이다.

[0005] 본 발명이 이루고자 하는 두 번째 기술적 과제는 상기 청색 또는 녹색 호스트 화합물을 이용한 유기전계발광소자를 제공하는 것이다.

과제 해결수단

[0006] 상기 첫 번째 기술적 과제를 달성하기 위해서, 본 발명은 하기 화학식 (1)로 표시되는 청색 또는 녹색 호스트 화합물을 제공한다.



[0007] (1)

[0009] 상기 식에서,

[0010] na는 나프탈렌기이며, A 및 B는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 치환 또는 비치환된 탄소수 1-20의 알킬기, 치환 또는 비치환의 탄소수 6 내지 40의 아릴기, 치환 또는 비치환의 탄소수 3 내지 20의 헥테로 아릴기, 게르마늄기, 보론기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 24의 알킬실릴기, 및 치환 또는 비치환의 탄소수 6-40의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 것이 바람직하며,

[0011] a는 0 내지 7의 정수이고, b는 1 내지 7의 정수이며, a 및 b가 2 이상의 경우 복수의 A 및 B는 각각 독립적으로 동일 또는 상이하다.

[0012] 본 발명의 다른 일실시예에 의하면, 상기 A 및 B의 치환기는 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 24의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 24의 시클로알킬기, 할로젠기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 24의 아릴

기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 24의 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 24의 헤테로아릴기, 게르마늄기, 보론기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 24의 알킬실릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6-40의 아릴실릴기 및 중수소로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 것이 바람직하다.

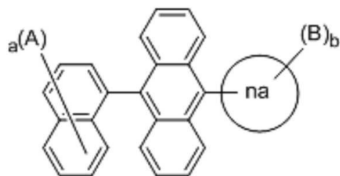
- [0013] 또한 본 발명은 상기 두 번째 기술적 과제를 해결하기 위하여, 애노드; 캐소드; 및 상기 애노드와 캐소드 사이에 상기 화학식 (1)에 따른 청색 또는 녹색 호스트 화합물이 함유된 층을 포함하는 유기전계발광소자를 제공한다.
- [0014] 본 발명의 일실시예에 의하면, 본 발명에 따른 청색 또는 녹색 호스트 화합물은 상기 애노드 및 캐소드 사이의 발광층 중에 포함되는 것이 바람직하다.
- [0015] 또한 본 발명의 다른 일실시예에 의하면, 상기 애노드 및 캐소드 사이에 정공주입층, 정공수송층, 전자저지층, 정공저지층, 전자전달층 및 전자주입층으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상의 층을 더 포함할 수 있으며, 상기 정공주입층, 정공수송층, 전자저지층, 발광층, 정공저지층, 전자수송층 및 전자주입층 중 적어도 한층 이상은 용액공정에 의하여 형성되어도 좋다.
- [0016] 또한 본 발명의 또 다른 일실시예에 의하면, 상기 발광층은 하기 실시예에 기재된 화학식 BD1 내지 BD68 또는 GD1 내지 GD60의 화합물 중 어느 하나 이상의 화합물을 더 포함할 수 있다.
- [0017] 또한 본 발명의 또 다른 일실시예에 의하면, 상기 발광층은 상기 화학식 (1)로 표시되는 화합물을 1종 이상 혼합하여 사용할 수도 있다.
- [0018] 또한 본 발명에 따른 유기전계발광소자는 표시소자, 디스플레이 소자 및 단색 또는 백색 조명용 소자에 유용하게 사용될 수 있다.

효 과

- [0019] 본 발명에 따른 화학식 (1)의 화합물을 애노드와 캐소드 사이의 박막층에 포함하는 유기전계발광소자는 청색 및 녹색의 호스트물질로서 휘도, 색순도 및 수명특성이 우수하기 때문에 디스플레이 및 조명 등에 유용하게 사용될 수 있다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

- [0020] 본 발명에 따른 청색 또는 녹색 호스트 화합물은 하기 화학식 (1)로 표시되는 것이 특징이다.



- [0021] 상기식에서
- [0022] na는 나프탈렌기이며, A 및 B는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 치환 또는 비치환된 탄소수 1-20의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 40의 아릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 20의 헤테로 아릴기, 게르마늄기, 보론기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 24의 알킬실릴기, 및 치환 또는 비치환된 탄소수 6-40의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 것이 바람직하며,
- [0023] a는 0 내지 7의 정수이고, b는 1 내지 7의 정수이며, a 및 b가 2 이상의 경우 복수의 A 및 B는 각각 독립적으로 동일 또는 상이하다,
- [0024] 본 발명의 다른 일실시예에 의하면, 상기 A 및 B의 치환기는 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 24의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 24의 시클로알킬기, 할로젠기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 24의 아릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 24의 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 24의 헤테로아릴기, 게르마늄기, 보론기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 24의 알킬실릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6-40의 아릴실릴기 및 중수소로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 것이 바람직하다.
- [0025] 본 발명에서 사용되는 치환기인 알킬기의 구체적인 예로는 메틸기, 에틸기, 프로필기, 이소부틸기, sec-부틸기,

tert-부틸기, 펜틸기, iso-아밀기, 헥실기, 헵틸기, 옥틸기, 스테아릴기, 트리클로로메틸기, 트리플루오르메틸기 등을 들 수 있으며, 상기 알킬기 중 하나 이상의 수소 원자는 중수소원자, 할로젠 원자, 히드록시기, 니트로기, 시아노기, 트리플루오로메틸기, 실릴기 (이 경우 "알킬실릴기"라 함), 치환 또는 비치환된 아미노기 (-NH₂, -NH(R), -N(R')(R''), R'과 R''은 서로 독립적으로 탄소수 1 내지 20의 알킬기이며, 이 경우 "알킬아미노기"라 함), 아미디노기, 히드라진기, 히드라존기, 카르복실기, 술폰산기, 인산기, 탄소수 1 내지 20의 알킬기, 탄소수 1 내지 20의 할로젠화된 알킬기, 탄소수 1 내지 20의 알케닐기, 탄소수 1 내지 20의 알키닐기, 탄소수 1 내지 20의 헤테로알킬기, 탄소수 6 내지 30의 아릴기, 탄소수 6 내지 60의 아릴알킬기, 탄소수 4 내지 40의 헤테로아릴기 또는 탄소수 4 내지 40의 헤테로아릴알킬기로 치환될 수 있다.

[0027] 본 발명의 화합물에서 사용되는 치환기인 시클로알킬기의 구체적인 예로는, 시클로 프로필기, 시클로펜틸기, 시클로헥실기, 시클로헵틸기, 시클로옥틸기, 아다만틸기 등을 들 수 있으며 상기 알킬기의 경우와 마찬가지로 치환기로 치환가능하다.

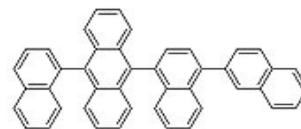
[0028] 본 발명의 화합물에서 사용되는 치환기인 알콕시기의 구체적인 예로는 메톡시기, 에톡시기, 프로폭시기, 이소부틸옥시기, sec-부틸옥시기, 펜틸옥시기, iso-아밀옥시기, 헥실옥시기 등을 들 수 있으며, 상기 알킬기의 경우와 마찬가지로 치환기로 치환가능하다.

[0029] 본 발명의 화합물에서 사용되는 치환기인 할로젠기의 구체적인 예로는 플루오르(F), 클로린(Cl), 브롬(Br)등을 들 수 있다.

[0030] 본 발명의 화합물에서 사용되는 치환기인 아릴기의 구체적인 예로는 페닐기, 2-메틸페닐기, 3-메틸페닐기, 4-메틸페닐기, 4-에틸페닐기, o-비페닐기, m-비페닐기, p-비페닐기, 4-메틸비페닐기, 4-에틸비페닐기, o-터페닐기, m-터페닐기, p-터페닐기, 1-나프틸기, 2-나프틸기, 1-메틸나프틸기, 2-메틸나프틸기, 안트릴기, 페난트릴기, 피레닐기, 플루오레닐기, 테트라히드로나프틸기 등과 같은 방향족 그룹을 들 수 있으며, 상기 알킬기의 경우와 마찬가지로 치환기로 치환가능하다.

[0031] 본 발명의 화합물에서 사용되는 치환기인 헤테로아릴기의 구체적인 예로는 피리디닐기, 피리미디닐기, 트리아지닐기, 인돌리닐기, 퀴놀린닐기, 피롤리디닐기, 피페리디닐기, 모폴리디닐기, 피페라디닐기, 카바졸릴기, 옥사졸릴기, 옥사디아졸릴기, 벤조옥사졸릴기, 치아졸릴기, 치아디아졸릴기, 벤조치아졸릴기, 트리아졸릴기, 이미다졸릴기 또는 벤조이미다졸기 등이 있으며, 상기 헤테로아릴기 중 하나 이상의 수소 원자는 상기 알킬기의 경우와 동일한 치환기로 치환가능하다.

[0032] 본 발명의 일구현예에 따른 청색 또는 녹색 호스트 화합물은 예를 들어, 하기 화학식 (H1) 내지 (H72)으로 표시되는 군으로부터 선택된 어느 하나의 화합물일 수 있으나, 이들 예시 화합물에 한정되는 것은 아니다.

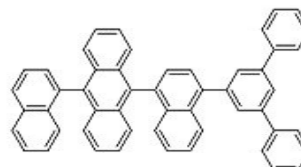
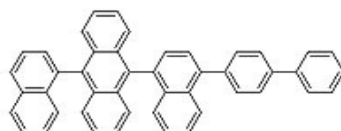
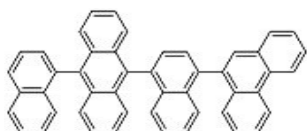


[0033]

[0034] (H1)

(H2)

(H3)

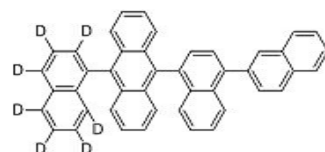
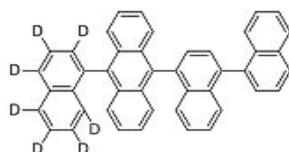
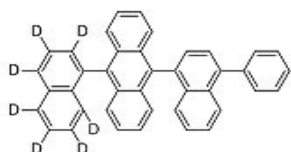


[0035]

[0036] (H4)

(H5)

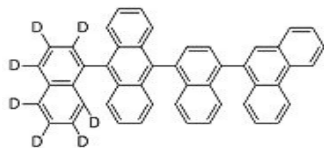
(H6)



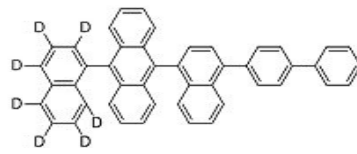
[0037]

[0038]

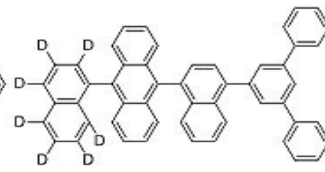
(H7)



(H8)



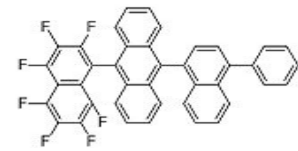
(H9)



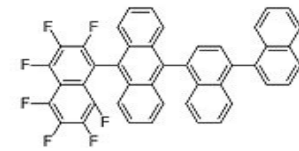
[0039]

[0040]

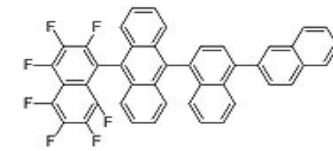
(H10)



(H11)



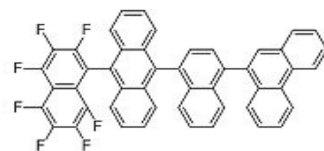
(H12)



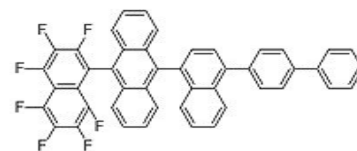
[0041]

[0042]

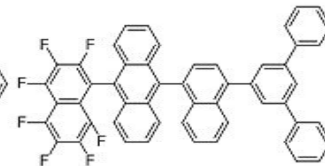
(H13)



(H14)



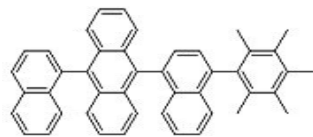
(H15)



[0043]

[0044]

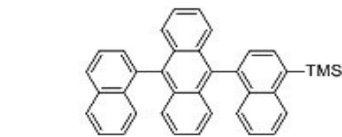
(H16)



(H17)



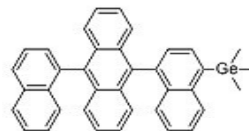
(H18)



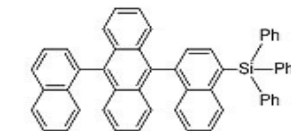
[0045]

[0046]

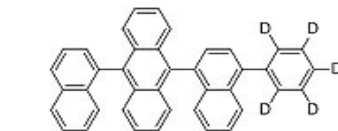
(H19)



(H20)



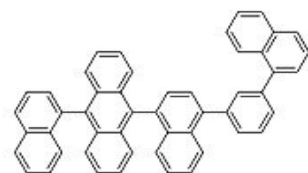
(H21)



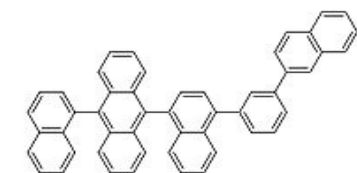
[0047]

[0048]

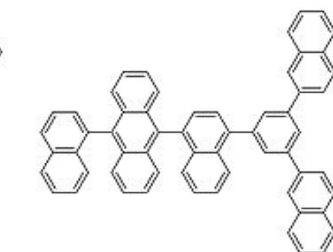
(H22)



(H23)



(H24)



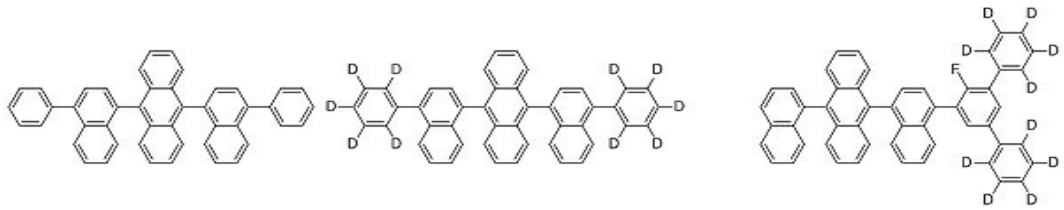
[0049]

[0050]

(H25)

(H26)

(H27)



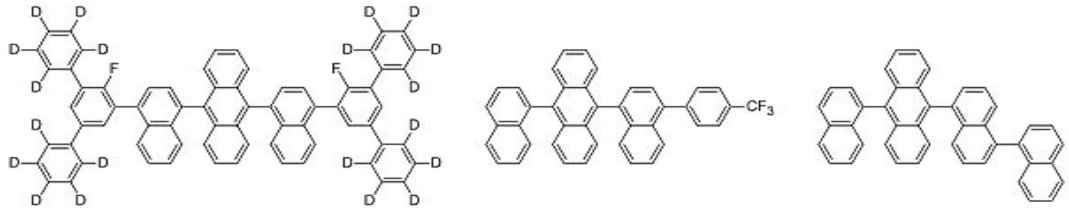
[0051]

[0052]

(H28)

(H29)

(H30)



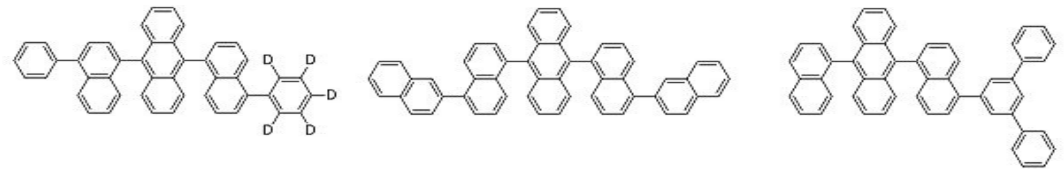
[0053]

[0054]

(H31)

(H32)

(H33)



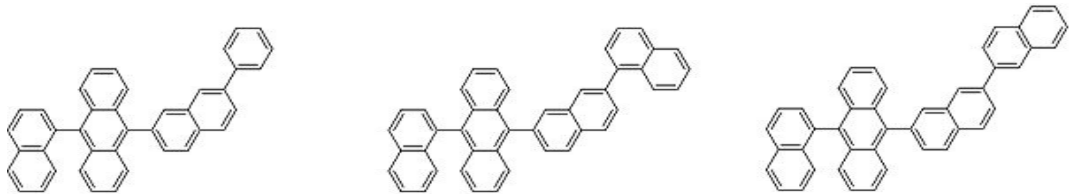
[0055]

[0056]

(H34)

(H35)

(H36)



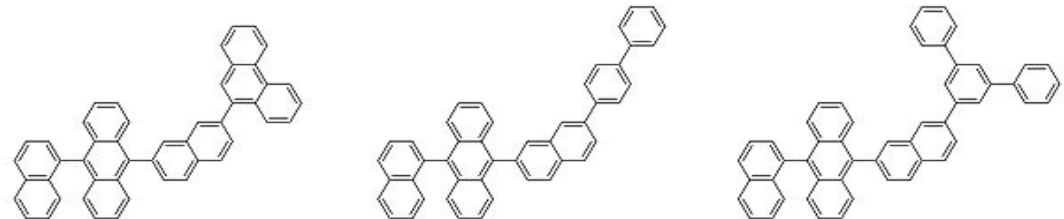
[0057]

[0058]

(H37)

(H38)

(H39)



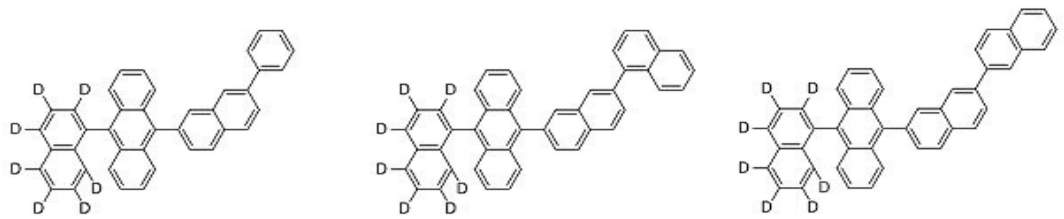
[0059]

[0060]

(H40)

(H41)

(H42)



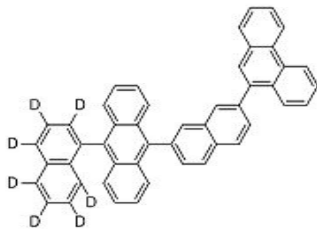
[0061]

[0062]

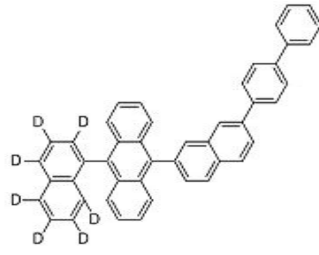
(H43)

(H44)

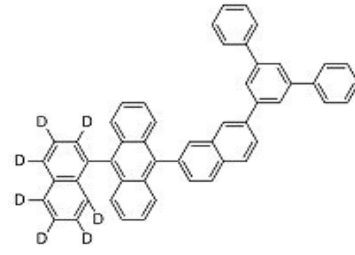
(H45)



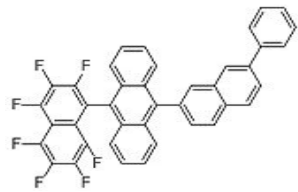
[0063]
[0064] (H46)



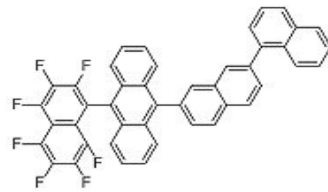
(H47)



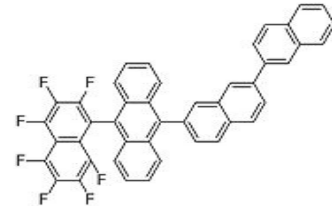
(H48)



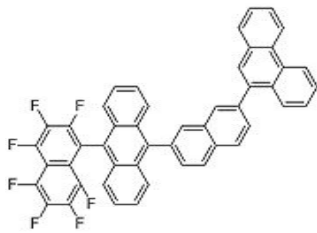
[0065]
[0066] (H49)



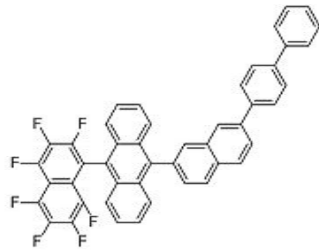
(H50)



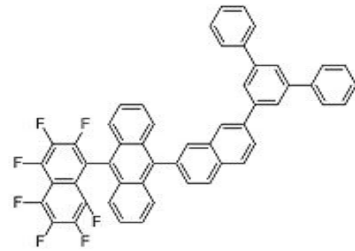
(H51)



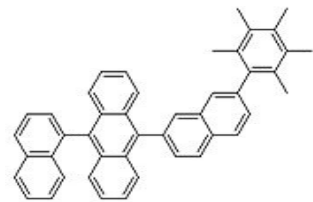
[0067]
[0068] (H52)



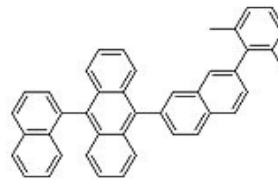
(H53)



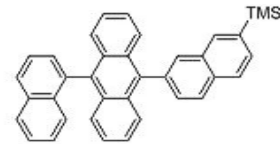
(H54)



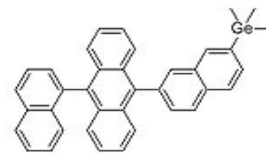
[0069]
[0070] (H55)



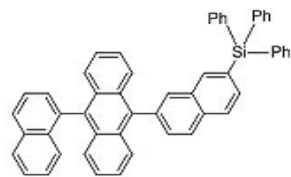
(H56)



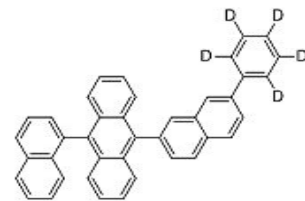
(H57)



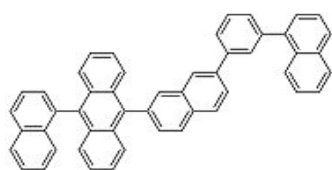
[0071]
[0072] (H58)



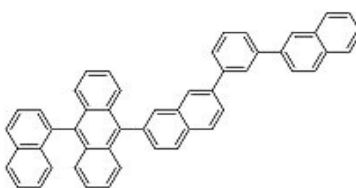
(H59)



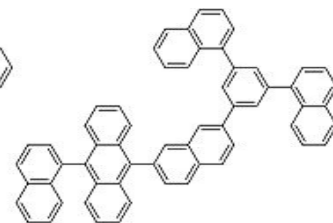
(H60)



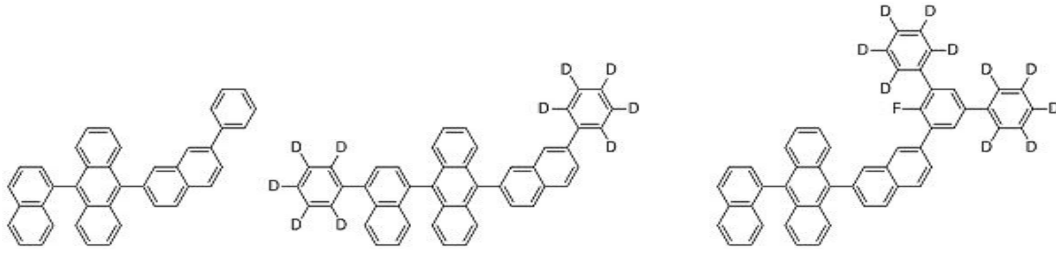
[0073]
[0074] (H61)



(H62)



(H63)



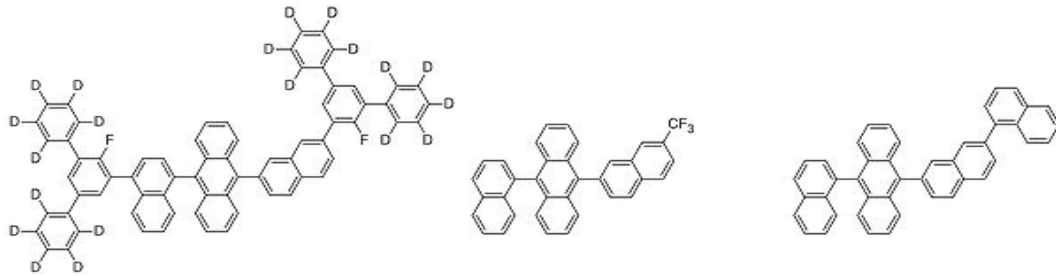
[0075]

[0076]

(H64)

(H65)

(H66)



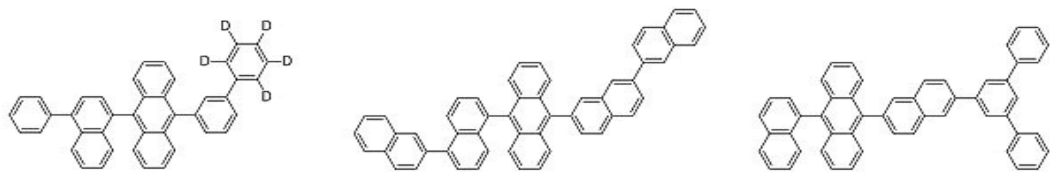
[0077]

[0078]

(H67)

(H68)

(H69)



[0079]

[0080]

(H70)

(H71)

(H72)

[0081]

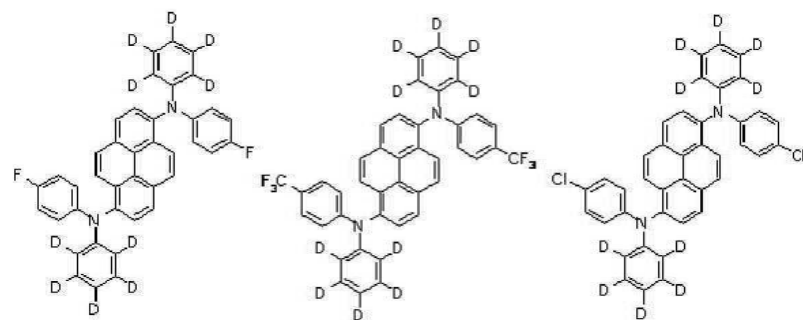
한편 본 발명에 따른 유기전계발광소자는 애노드; 캐소드; 및 애노드와 캐소드 사이에 상기 화학식 (1)에 따른 청색 또는 녹색 호스트 화합물이 함유된 층을 포함하는 것이 특징이다. 이때, 본 발명의 일구현예에 따른 안트라센계 화합물은 상기 애노드 및 캐소드 사이의 발광층에 포함되는 것이 바람직하며, 상기 애노드 및 캐소드 사이에 정공주입층, 정공수송층, 정공저지층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 및 전자저지층으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상의 층을 더 포함할 수 있다.

[0082]

또한 본 발명의 다른 일실시예에 의하면, 상기 정공주입층, 정공수송층, 정공저지층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 및 전자저지층 중 적어도 한층 이상이 용액공정에 의하여 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자를 제공한다.

[0083]

또한 본 발명의 또 다른 실시예에 의하면, 상기 발광층은 하기 화학식 BD1 내지 BD68 또는 GD1 내지 GD60의 화합물 중 어느 하나 이상의 화합물을 더 포함할 수 있으며, 이에 따라 성능이 향상될 수 있다.



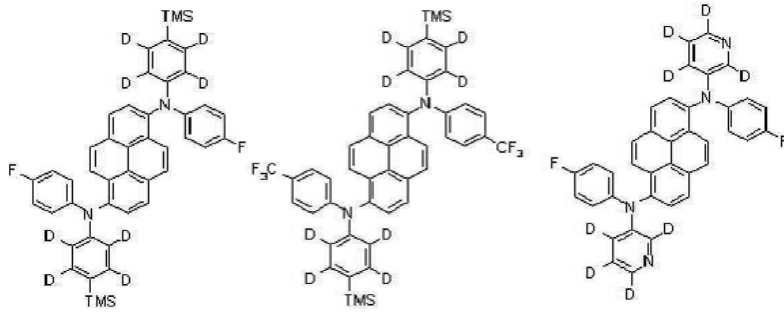
[0084]

[0085]

B D 1

B D 2

B D 3



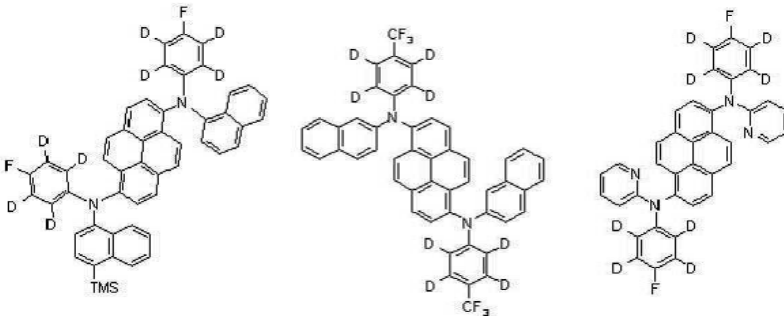
[0086]

[0087]

BD 4

BD 5

BD 6



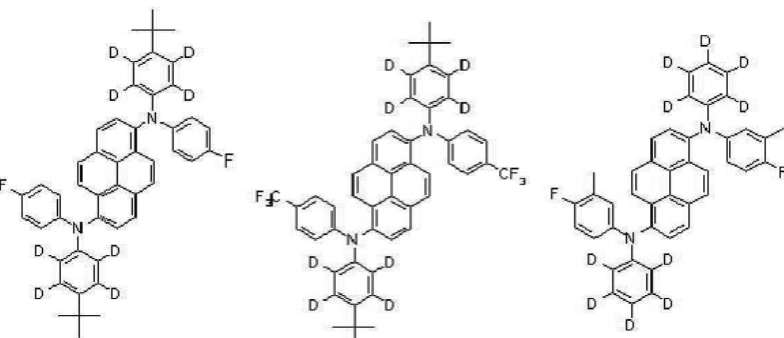
[0088]

[0089]

BD 7

BD 8

BD 9



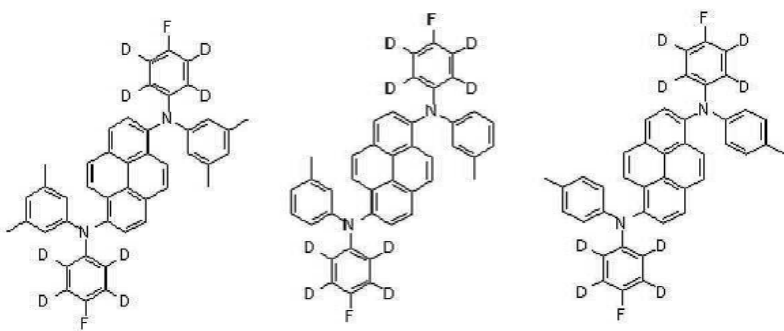
[0090]

[0091]

BD 10

BD 11

BD 12



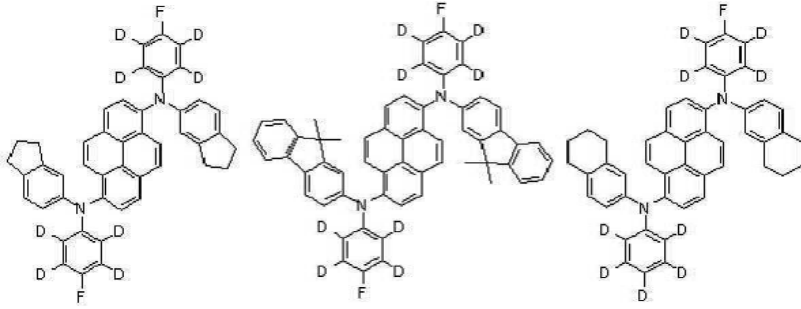
[0092]

[0093]

BD 13

BD 14

BD 15



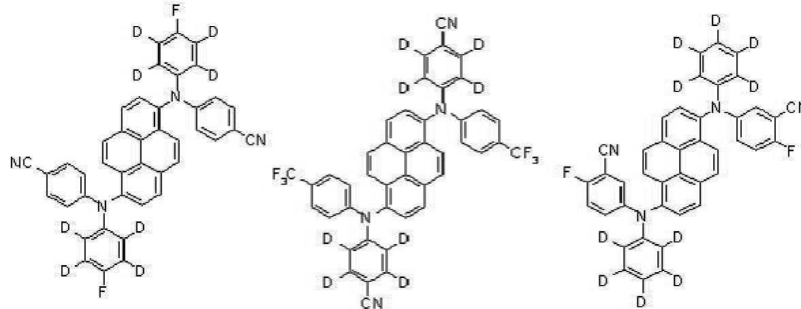
[0094]

[0095]

BD 16

BD 17

BD 18



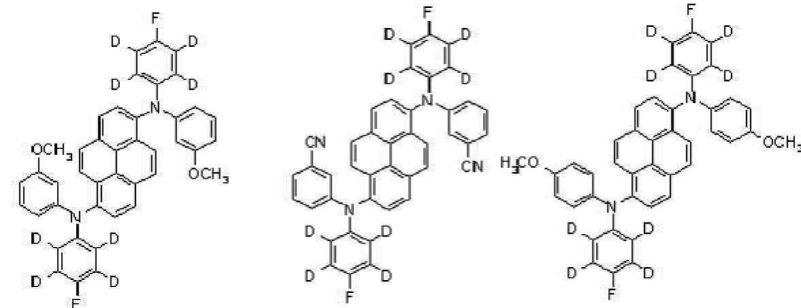
[0096]

[0097]

BD 19

BD 20

BD 21



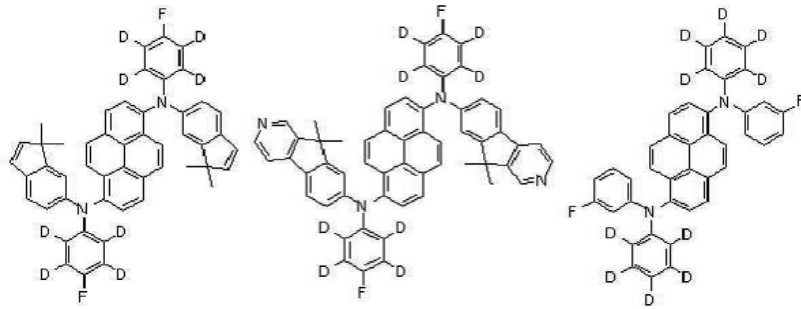
[0098]

[0099]

BD 22

BD 23

BD 24



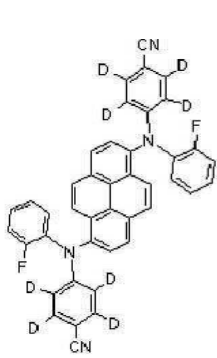
[0100]

[0101]

BD 25

BD 26

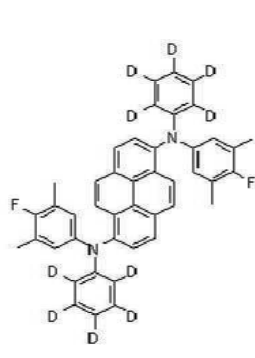
BD 27



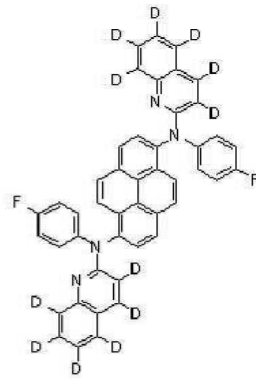
[0102]

[0103]

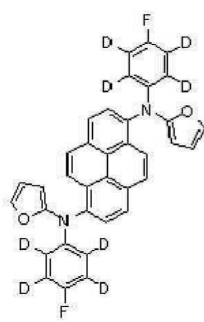
BD 28



BD 29



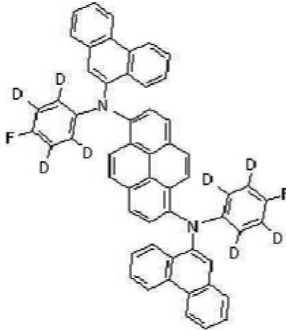
BD 30



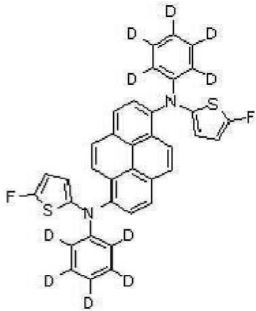
[0104]

[0105]

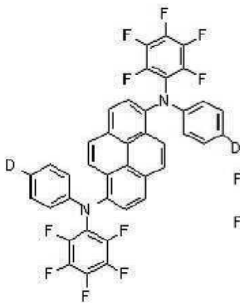
BD 31



BD 32



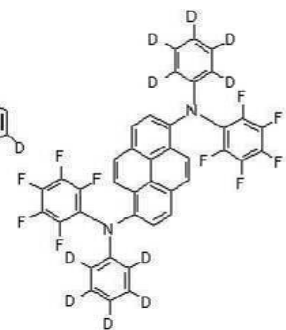
BD 33



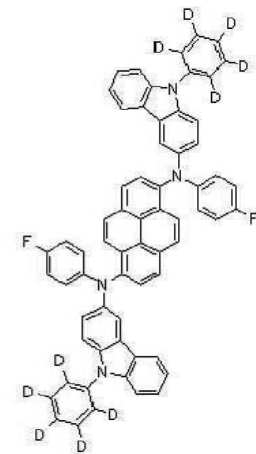
[0106]

[0107]

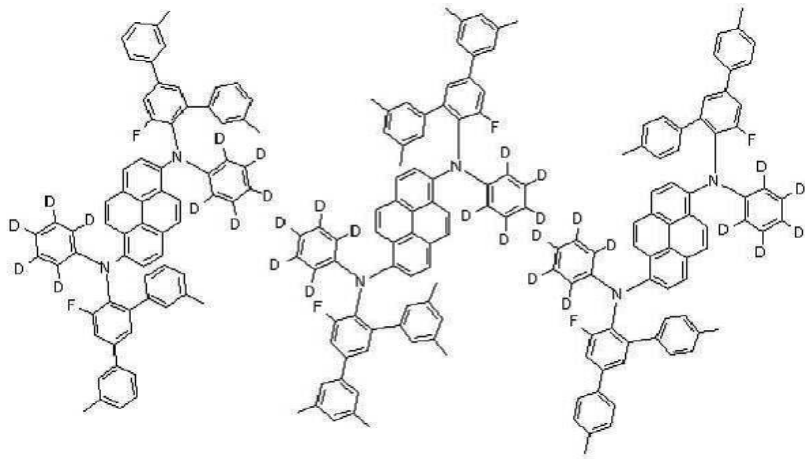
BD 34



BD 35



BD 36



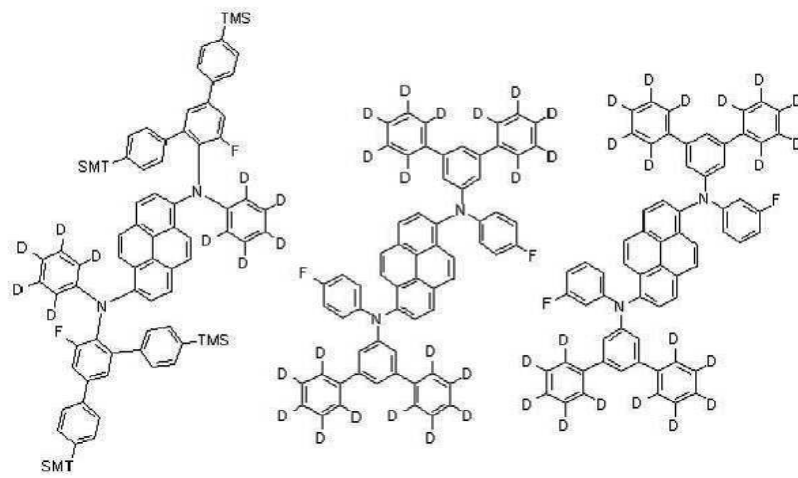
[0108]

[0109]

BD 37

BD 38

BD 39

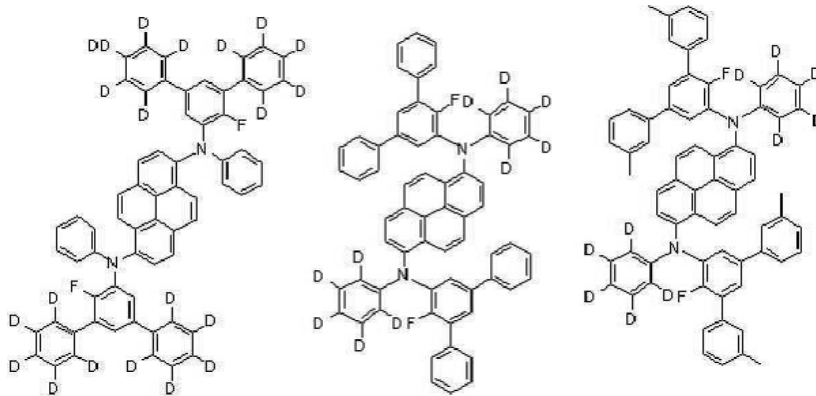


[0110]

BD 40

BD 41

BD 42



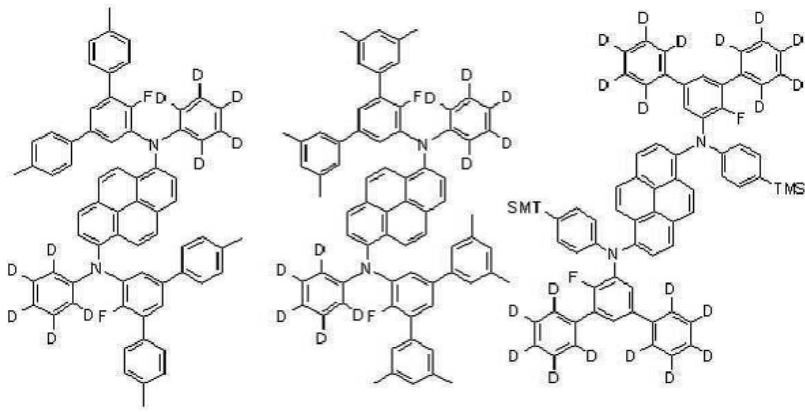
[0111]

[0112]

BD 43

BD 44

BD 45



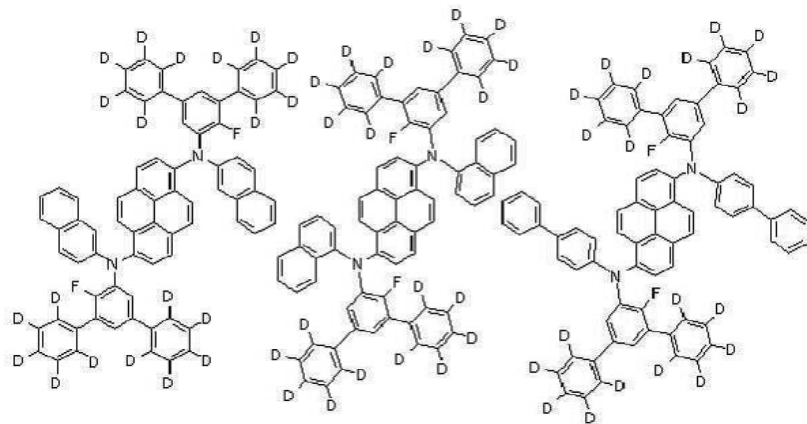
[0113]

[0114]

BD 4 6

BD 4 7

BD 4 8



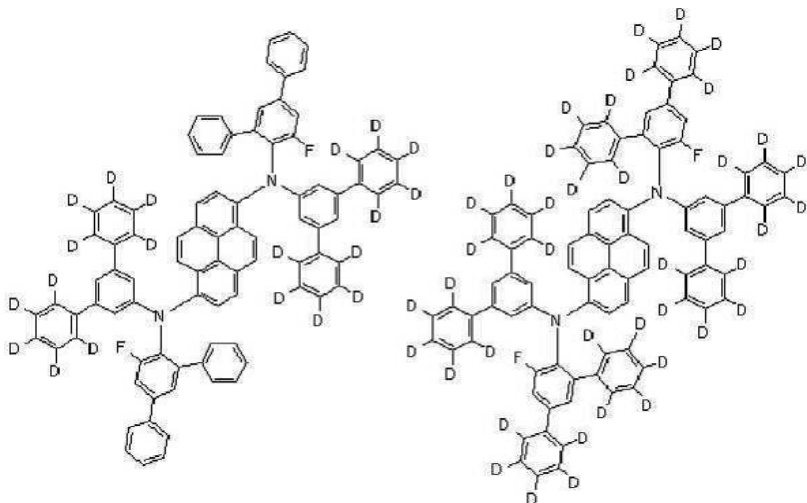
[0115]

[0116]

BD 4 9

BD 5 0

BD 5 1

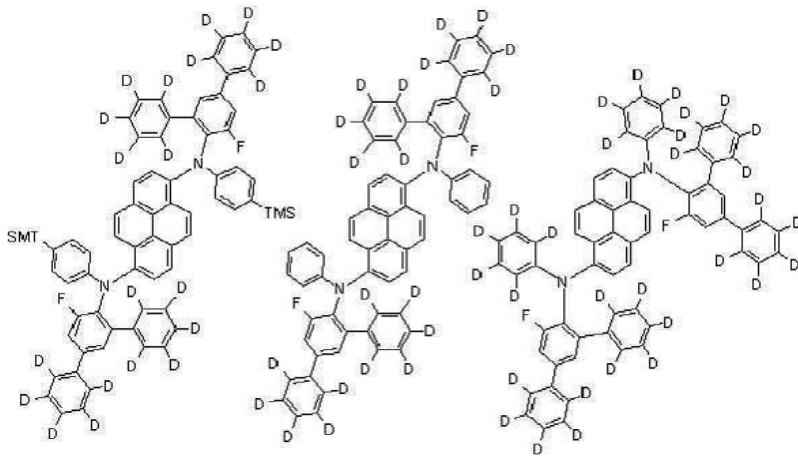


[0117]

[0118]

BD 5 2

BD 5 3



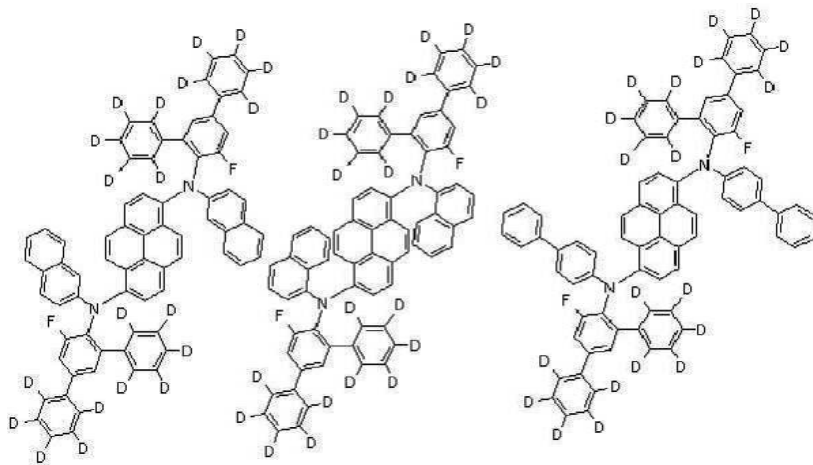
[0119]

[0120]

BD 5 4

BD 5 5

BD 5 6



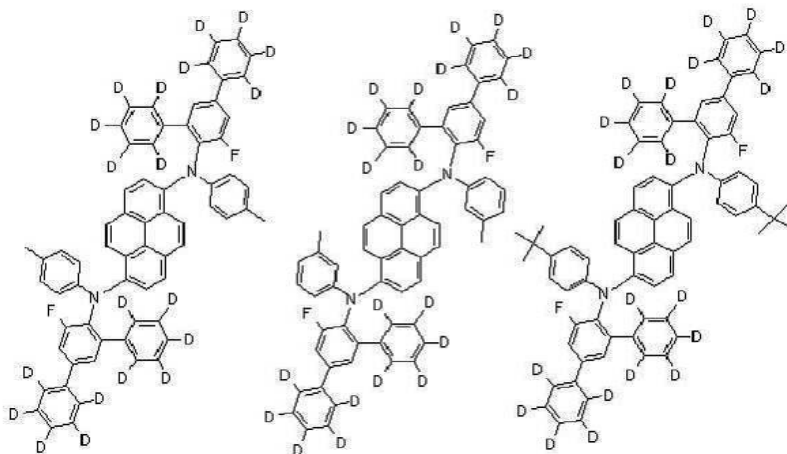
[0121]

[0122]

BD 5 7

BD 5 8

BD 5 9



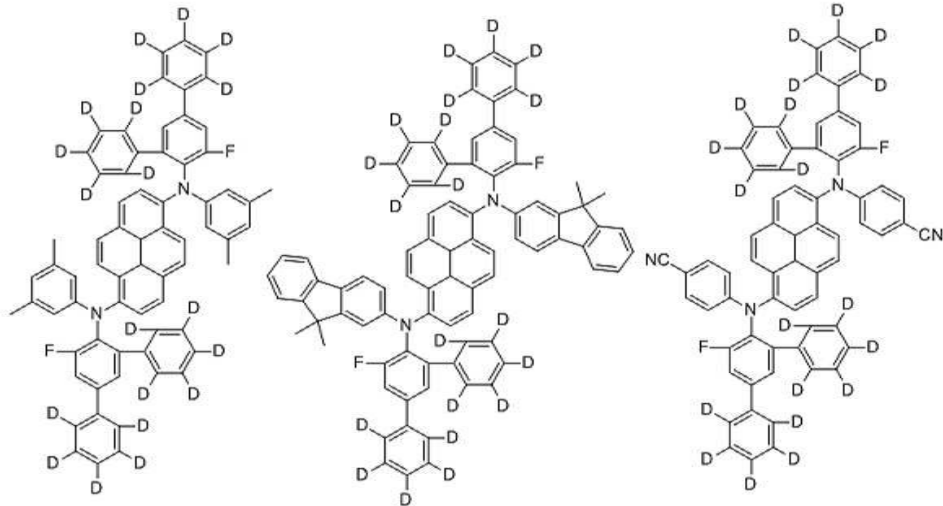
[0123]

[0124]

BD 6 0

BD 6 1

BD 6 2



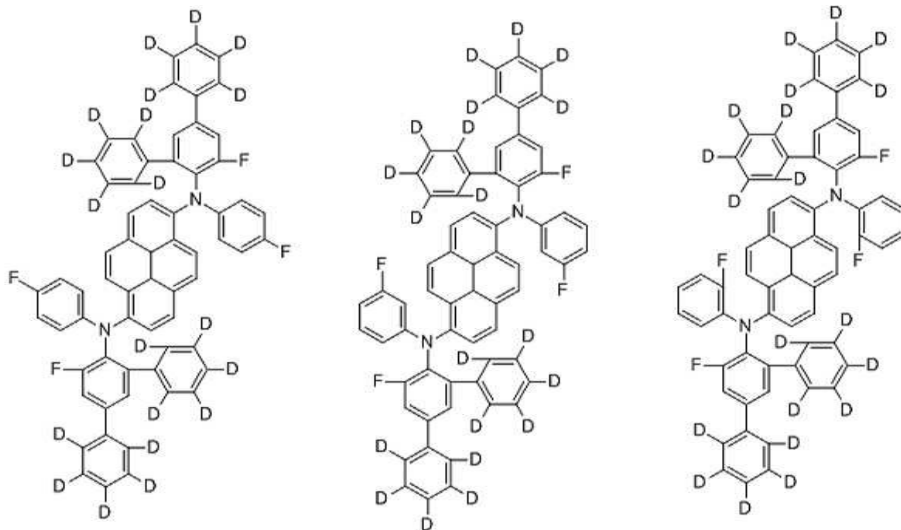
[0125]

[0126]

BD63

BD64

BD65



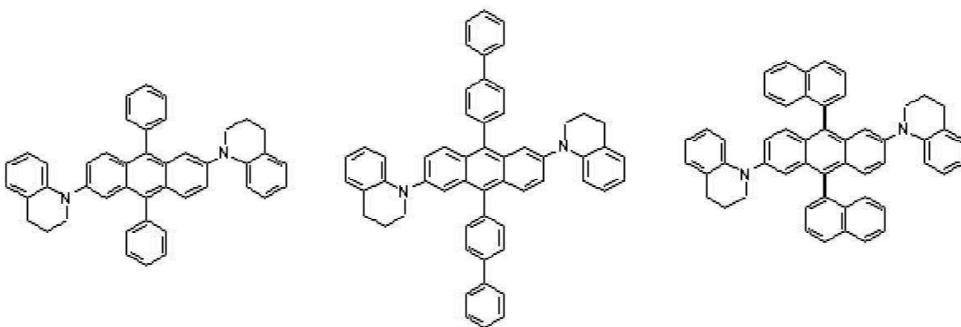
[0127]

[0128]

BD66

BD67

BD68



[0129]

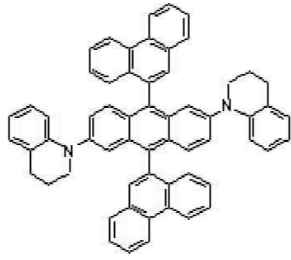
[0130]

GD1

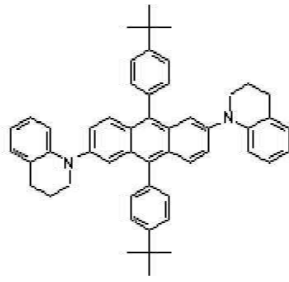
GD2

GD3

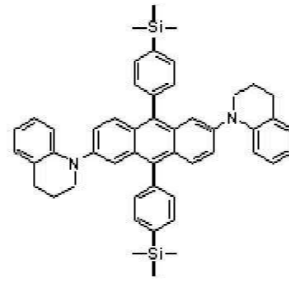




GD4



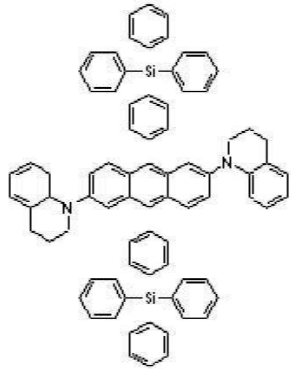
GD5



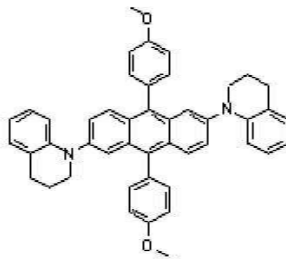
GD6

[0131]

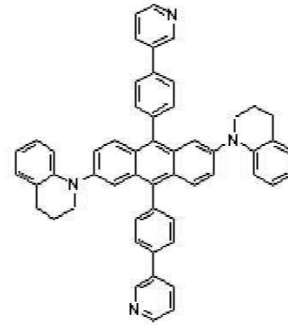
[0132]



GD7

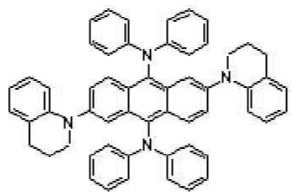


GD8

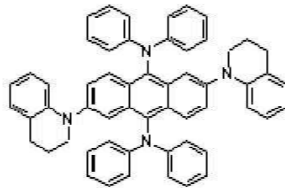


GD9

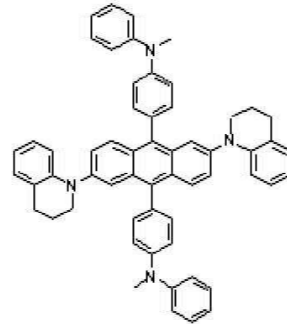
[0133]



GD10

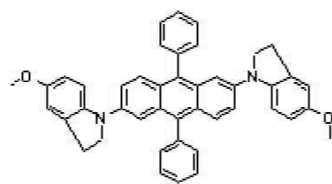


GD11

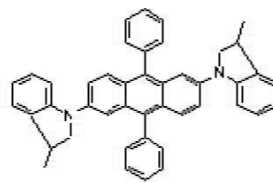


GD12

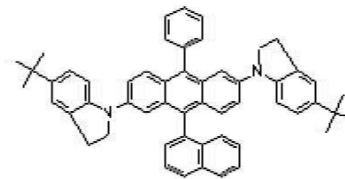
[0134]



GD13

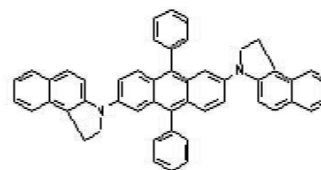
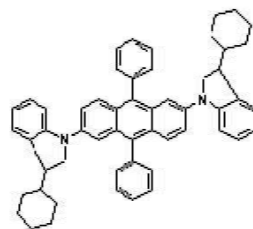
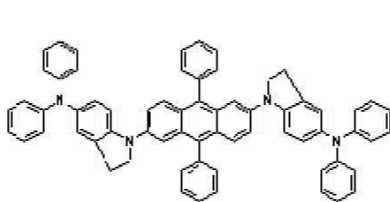


GD14



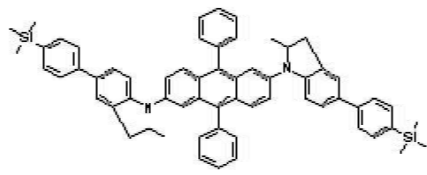
GD15

[0135]

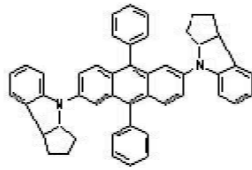


[0136]

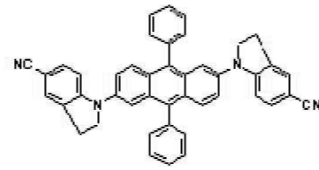
GD16



GD17

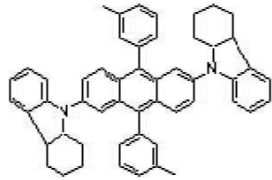


GD18

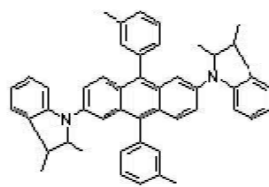


[0137]

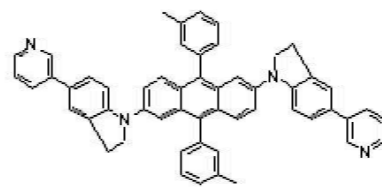
GD19



GD20



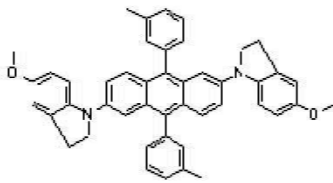
GD21



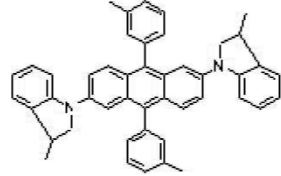
[0138]

[0139]

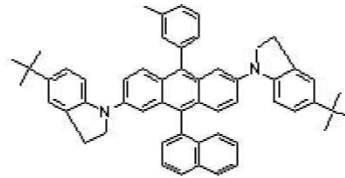
GD22



GD23

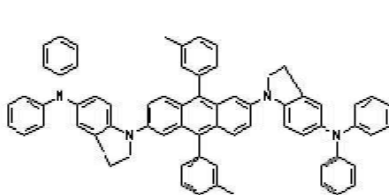


GD24

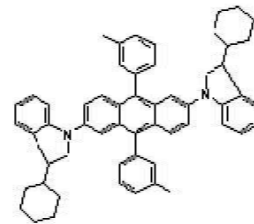


[0140]

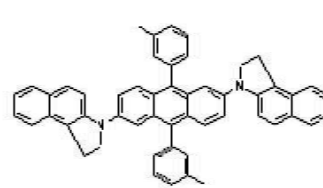
GD25



GD26



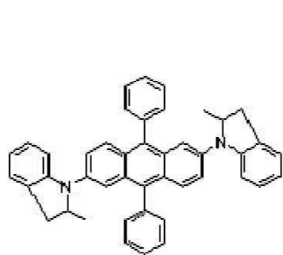
GD27



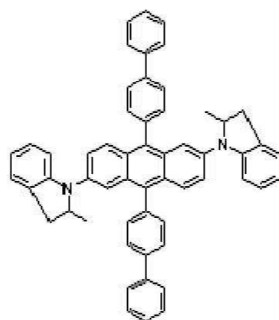
[0141]

[0142]

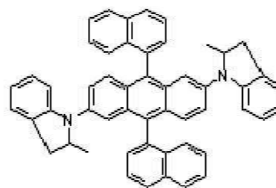
GD28



GD29



GD30



[0143]

[0144]

GD31

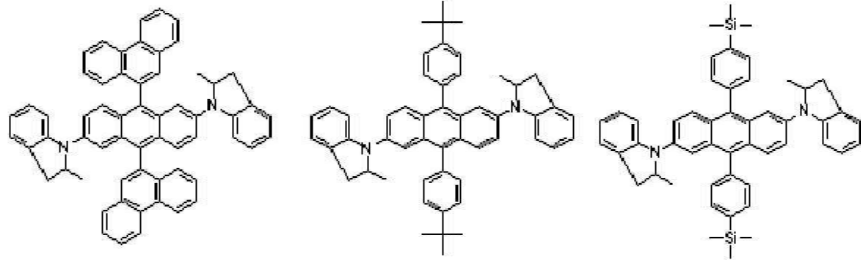


GD32



GD33





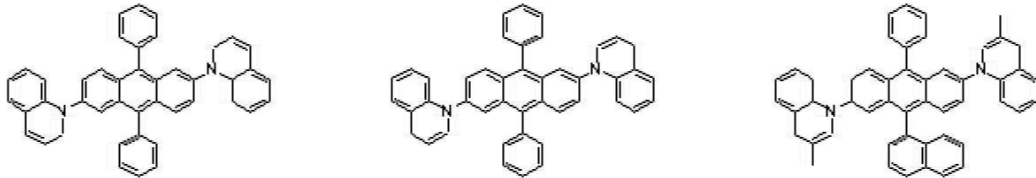
[0145]

[0146]

GD34

GD35

GD36

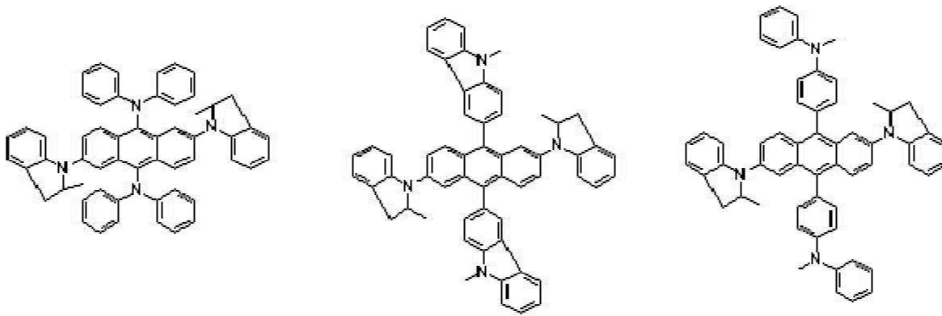


[0147]

GD37

GD38

GD39

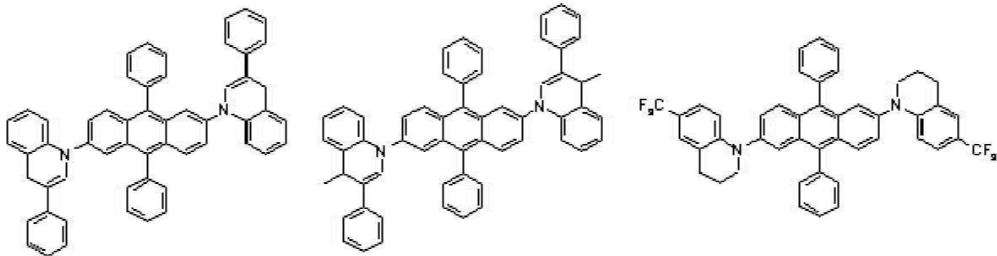


[0148]

GD40

GD41

GD42

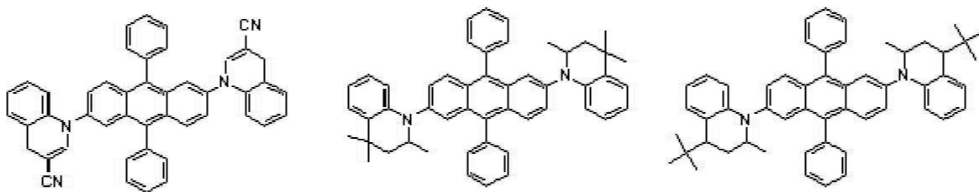


[0149]

GD43

GD44

GD45

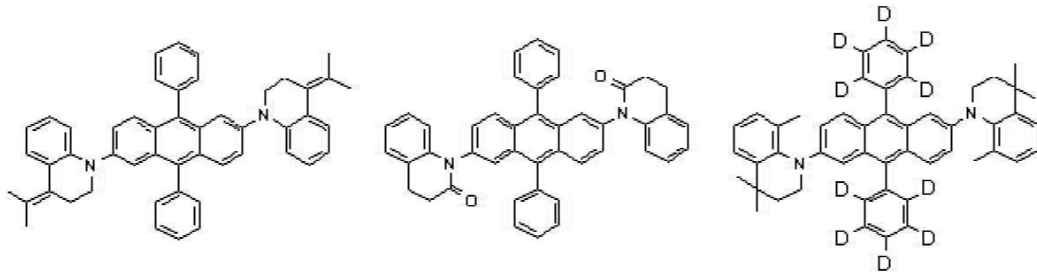


[0150]

GD46

GD47

GD48



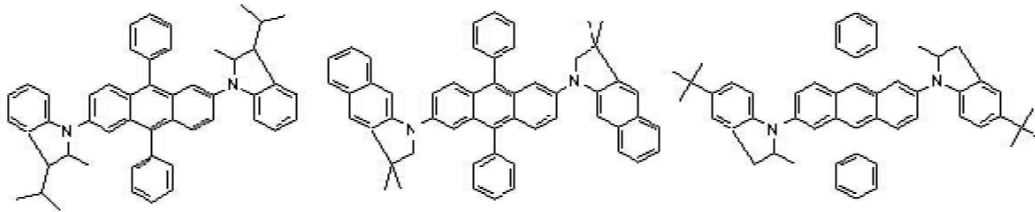
[0151]

[0152]

GD49

GD50

GD51

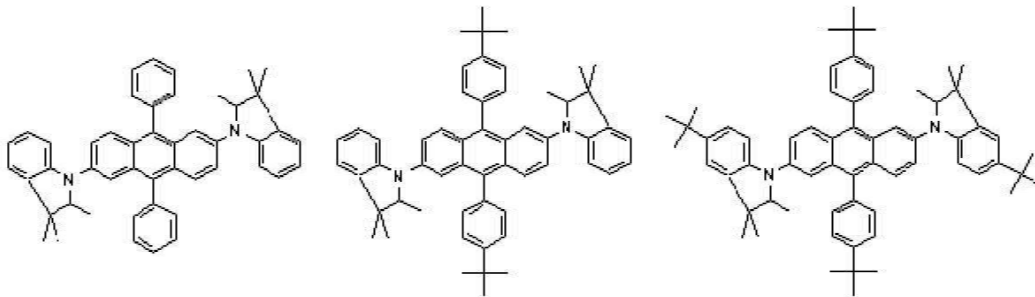


[0153]

GD52

GD53

GD54

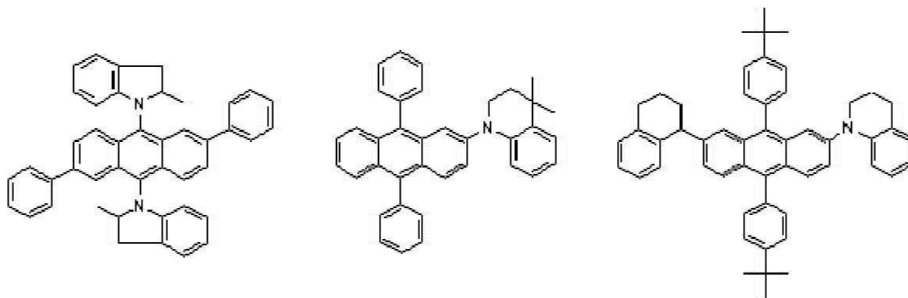


[0154]

GD55

GD56

GD57



[0155]

GD58

GD59

GD60

[0156]

또한 본 발명에 따른 유기전계발광소자는 표시소자, 디스플레이 소자 및 단색 또는 백색 조명용 소자에 사용하는 것이 바람직하다.

[0157]

구체적인 예로서, 정공수송층(HTL: Hole Transport Layer)이 추가로 적층되어 있고, 상기 캐소드와 상기 유기발광층 사이에 전자수송층(ETL: Electron Transport Layer)이 추가로 적층되어 있는 것일 수 있는데, 상기 정공수송층은 애노드로부터 정공을 주입하기 쉽게 하기 위하여 적층되는 것으로서, 상기 정공수송층의 재료로는 이온화 포텐셜이 작은 전자공여성 분자가 사용되는데, 주로 트리페닐아민을 기본골격으로 하는 디아민, 트리아민 또는 테트라아민 유도체가 많이 사용되고 있다.

[0158]

본 발명에서도 상기 정공수송층의 재료로서 당업계에 통상적으로 사용되는 것인 한 특별히 제한되지 않으며, 예를 들어, N,N'-비스(3-메틸페닐)-N,N'-디페닐-[1,1'-비페닐]-4,4'-디아민(TPD) 또는 N,N'-디(나프탈렌-1-일)-N,N'-디페닐 벤지딘(a-NPD) 등을 사용할 수 있다.

[0159]

상기 정공수송층의 하부에는 정공주입층(HIL: Hole Injecting Layer)을 추가적으로 더 적층할 수 있는데, 상기

정공주입층 재료 역시 당업계에서 통상적으로 사용되는 것인 한 특별히 제한되지 않고 사용할 수 있으며, 예를 들어 하기 화학식으로 열거되어 있는 CuPc 또는 스타버스트(Starburst)형 아민류인 TCTA, m-MTDATA 등을 사용할 수 있다.

[0160] 또한, 본 발명에 따른 유기전계발광소자에 사용되는 상기 전자수송층은 캐소드로부터 공급된 전자를 유기발광층으로 원활히 수송하고 상기 유기발광층에서 결합하지 못한 정공의 이동을 억제함으로써 발광층 내에서 재결합할 수 있는 기회를 증가시키는 역할을 한다. 상기 전자수송층 재료로는 당업계에서 통상적으로 사용되는 것이면 특별히 제한되지 않고 사용할 수 있음은 물론이며, 예를 들어, 옥사디아졸 유도체인 PBD, BMD, BND 또는 Alq₃ 등을 사용할 수 있다.

[0161] 한편 상기 전자수송층의 상부에는 캐소드로부터의 전자 주입을 용이하게 해주어 궁극적으로 파워효율을 개선시키는 기능을 수행하는 전자주입층(EIL: Electron Injecting Layer)을 더 적층시킬 수도 있는데, 상기 전자주입층 재료 역시 당업계에서 통상적으로 사용되는 것이면 특별한 제한없이 사용할 수 있으며, 예를 들어, LiF, NaCl, CsF, Li₂O, BaO 등의 물질을 이용할 수 있다.

[0162] 또한 본 발명의 일실시예에 의하면, 본 발명에 따른 유기전계발광소자는 표시소자, 디스플레이 소자 및 단색 또는 백색 조명용 소자에 사용하는 것이 바람직하다. 또한 본 발명에 따른 화합물은 유기전계발광소자에 사용될 뿐만 아니라, 유기박막트랜지스터(OTFT), RFID(Radio-Frequency Identification) 등에 사용될 수 있다.

[0163] 도 1은 본 발명의 유기전계발광 소자의 구조를 나타내는 단면도이다. 본 발명에 따른 유기발광 다이오드는 애노드(20), 정공수송층(40), 유기발광층(50), 전자수송층(60) 및 캐소드(80)를 포함하며, 필요에 따라 정공주입층(30)과 전자주입층(70)을 더 포함할 수 있으며, 그 이외에도 1층 또는 2층의 중간층을 더 형성하는 것도 가능하며, 정공저지층 또는 전자저지층을 더 형성시킬 수도 있다.

[0164] 도 1을 참조하여 본 발명의 유기전계발광소자 및 그 제조 방법에 대하여 살펴보면, 다음과 같다. 먼저 기판(10) 상부에 애노드 전극용 물질을 코팅하여 애노드(20)를 형성한다. 여기에서 기판(10)으로는 통상적인 유기 EL 소자에서 사용되는 기판을 사용하는데 투명성, 표면 평활성, 취급용이성 및 방수성이 우수한 유기 기판 또는 투명 플라스틱 기판이 바람직하다. 그리고 애노드 전극용 물질로는 투명하고 전도성이 우수한 산화인듐주석(ITO), 산화인듐아연(IZO), 산화주석(SnO₂), 산화아연(ZnO) 등을 사용한다.

[0165] 상기 애노드(20) 전극 상부에 정공 주입층 물질을 진공열 증착, 또는 스핀 코팅하여 정공주입층(30)을 형성한다. 그 다음으로 상기 정공주입층(30)의 상부에 정공수송층 물질을 진공 열증착 또는 스핀 코팅하여 정공수송층(40)을 형성한다. 이어서, 상기 정공수송층(40)의 상부에 유기발광층(50)을 적층하고 상기 유기발광층(50)의 상부에 선택적으로 정공저지층(미도시)을 진공 증착 방법, 또는 스핀 코팅 방법으로서 박막을 형성할 수 있다. 상기 정공저지층은 정공이 유기발광층을 통과하여 캐소드로 유입되는 경우에는 소자의 수명과 효율이 감소되기 때문에 HOMO 레벨이 매우 낮은 물질을 사용함으로써 이러한 문제를 방지하는 역할을 한다. 이때 사용되는 정공 저지 물질은 특별히 제한되지는 않으나 전자수송능력을 가지면서 발광 화합물보다 높은 이온화 포텐셜을 가져야 하며 대표적으로 BA1q, BCP, TPBI 등이 사용될 수 있다.

[0166] 이러한 정공저지층 위에 전자수송층(60)을 진공 증착 방법, 또는 스핀 코팅 방법을 통해 증착한 후에 전자주입층(70)을 형성하고 상기 전자주입층(70)의 상부에 캐소드 형성용 금속을 진공 열증착하여 캐소드(80) 전극을 형성함으로써 유기 EL 소자가 완성된다. 여기에서 캐소드 형성용 금속으로는 리튬(Li), 마그네슘(Mg), 알루미늄(Al), 알루미늄-리튬(Al-Li), 칼슘(Ca), 마그네슘-인듐(Mg-In), 마그네슘-은(Mg-Ag) 등을 사용할 수 있으며, 전면 발광 소자를 얻기 위해서는 ITO, IZO를 사용한 투과형 캐소드를 사용할 수 있다.

[0167] 이하, 본 발명을 하기 실시예를 통하여 본 발명을 보다 상세하게 설명하고자 하나, 하기의 실시예는 단지 설명의 목적을 위한 것으로 본 발명을 제한하기 위한 것은 아니다.

[0168] **합성예 1: 화학식 H3의 합성**

[0169] 합성예 1-(1) : 9-브로모-10-(1-나프틸)안트라센의 합성

[0170] 500ml 등근 바닥 플라스크에 9,-브로모안트라센 20g(0.078mol), 1-나프탈렌보론산 16.0 g(0.093mol), 탄산칼륨(K₂CO₃) 21.5 g(0.156mol), 테트라키스트리페닐포스핀팔라듐 (Pd(PPh₃)₄) 4.49 g(0.004mol), 물 20mL, 톨루엔 100ml 및 테트라하이드로퓨란 100mL를 투입하고 24시간 동안 환류시켰다. 반응이 종결되면, 반응의 결과물을 층

분리하여 수층을 제거하고 유기층을 분리하여 감압농축한 후, 헥산과 디클로로메탄을 전개용매로 사용하여 칼럼 크로마토그래피로 분리하여 얻은 고체를 건조한 결과, 9.64 g (수율 65%)의 흰색 고체를 얻었다.

[0171]

합성예 1-(2) 9-브로모-10-(1-나프틸)안트라센의 합성

[0172]

500ml 둥근 바닥 플라스크에 9-(1-나프틸)안트라센 20g(0.066mol)을 클로로포름 250ml에 녹인 후 브롬 12.6g(0.076mol)을 클로로포름 50ml에 희석시킨 용액을 천천히 적가한다. 적가 후 12시간 동안 교반시킨다. 반응 종료 후 물 300ml를 넣어 추출한 후 유기층을 무수처리한다. 여액을 감압농축한 후, 생긴 고체를 디클로로메탄 100ml에 녹인 후 헥산 200ml를 넣어 고체를 석출시킨다. 생긴 고체를 여과한 후 톨루엔 50ml에 끓인 후 식혀 결정을 석출시켜 여과한다. 연노란색의 고체 9-브로모-10-(1-나프틸)안트라센 28g(수율 88 %)을 얻었다.

[0173]

합성예 1-(3) 1,4-디브로모나프탈렌의 합성

[0174]

1000 mL 둥근바닥 플라스크에 1-브로모나프탈렌 100g(0.483 mol)을 500 mL의 염화메틸렌에 녹인다. 상기 플라스크를 영하 18도로 온도를 낮춘다. 이 용액에 브롬 83g (0.531 mol)을 염화메틸렌 100 mL에 희석시켜 적가한다. 이 용액을 냉장고에 24시간 넣어둔다. 반응 후 생긴 고체를 여과하고, 헥산으로 재결정하여 백색의 1,4-디브로모나프탈렌 94g(68%)을 얻었다.

[0175]

합성예 1-(4) 1-브로모-4-(2-나프틸)나프탈렌의 합성

[0176]

250ml 둥근 바닥 플라스크에 나프탈렌-2-보론산 20g(0.116mol), 1,4-디브로모나프탈렌 40g(0.140mol), 탄산칼륨(K₂CO₃) 24.1 g(0.174mol), 테트라키스트리페닐포스핀팔라듐 (Pd(PPh₃)₄) 6.72 g(0.006mol), 물 20mL, 톨루엔 100ml 및 테트라하이드로퓨란 100mL를 투입하고 24시간 동안 환류시켰다. 반응이 종결되면, 반응의 결과물을 층 분리하여 수층을 제거하고 유기층을 분리하여 감압농축한 후, 헥산과 디클로로메탄을 전개용매로 사용하여 칼럼 크로마토그래피로 분리하여 얻은 고체를 건조한 결과, 34 g(수율 87%)의 흰색 고체를 얻었다.

[0177]

합성예 1-(5) 4-(2-나프틸)나프탈렌-1-보론산의 합성

[0178]

500ml 둥근 바닥 플라스크에 질소 분위기 하에서 1-브로모-4-(2-나프틸)나프탈렌 20g(0.060mol)을 테트라하이드로퓨란 250ml에 녹인 후 영하 70도로 냉각한다. 냉각 후 n-부틸리튬(1.6M 헥산용액) 45 mL(0.072mol)을 천천히 적가한다. 저온을 유지하며 1시간 교반한 후 트리메틸보레이트 11 mL(0.090 mol)을 적가한 후 상온에서 1시간 교반시킨다. 반응 종료 후 2N HCl 용액 100ml를 적가한 후 에틸아세테이트 와 물을 넣고 추출한다. 유기층을 무수처리한 후 감압하여 유기용매를 제거한다. 생긴 고체를 에틸아세테이트 30ml에 녹인 후 헥산 200ml를 넣고 재결정다. 생긴 고체를 여과하여 백색의 4-(2-나프틸)나프탈렌-1-보론산 14.5g(수율 84%)를 얻었다.

[0179]

합성예 1-(6) 화학식 H3의 합성

[0180]

500ml 둥근 바닥 플라스크에 9-브로모-10-(1-나프틸)안트라센 12g(0.031mol), 4-(2-나프틸)나프탈렌-1-보론산 10.3g(0.034mol), 탄산칼륨(K₂CO₃) 6.49 g(0.047mol), 테트라키스트리페닐포스핀팔라듐 (Pd(PPh₃)₄) 1.81 g(0.002mol), 물 20mL, 톨루엔 80ml 및 테트라하이드로퓨란 80mL를 투입하고 24시간 동안 환류시켰다. 반응이 종결되면, 반응의 결과물을 층 분리하여 수층을 제거하고 유기층을 분리하여 감압농축한 후, 헥산과 디클로로메탄을 전개용매로 사용하여 칼럼크로마토그래피로 분리하여 얻은 고체를 건조한 결과, 9.8 g(수율 56%)의 흰색 고체를 얻었다.

[0181]

MS(MALDI-TOF): m/z 556 [M]⁺

[0182]

합성예 2: 화학식 H24의 합성

[0183]

합성예 1-(6)중 4-(2-나프틸)나프탈렌-1-보론산 대신 4-(페닐-d5) 나프탈렌-1-보론산을 사용한 것을 제외하고 합성예1과 동일한 방법으로 합성하여 H24 7g(수율 63%)을 얻었다.

[0184]

MS(MALDI-TOF): m/z 511 [M]⁺

[0185]

합성예 3: 화학식 H29의 합성

[0186]

500ml 둥근 바닥 플라스크에 9,10-디브로모안트라센 8g(0.024mol), 4-(2-나프틸)나프탈렌-1-보론산 15.7g(0.060mol), 탄산칼륨(K₂CO₃) 9.9 g(0.071mol), 테트라키스트리페닐포스핀팔라듐 (Pd(PPh₃)₄) 1.38 g, 물 40mL, 톨루엔 100ml 및 테트라하이드로퓨란 100mL를 투입하고 24시간 동안 환류시켰다. 반응이 종결되면, 반응의 결과물을 층 분리하여 수층을 제거하고 유기층을 분리하여 감압농축한 후, 헥산과 디클로로메탄을 전개용매

로 사용하여 칼럼크로마토그래피로 분리하여 얻은 고체를 건조한 결과, 7.5 g(수율 53%)의 흰색 고체를 얻었다.

[0187] MS(MALDI-TOF): m/z 592 [M]⁺

[0188] **합성예 4: 화학식 H64의 합성**

[0189] 합성예 4-(1) 7-페닐나프탈렌-2-보론산 합성

[0190] 합성예 1-(5)에서 1-브로모-4-(1-나프틸)나프탈렌 대신 2-브로모-7-페닐나프탈렌을 사용한 것을 제외하고 동일한 방법으로 7-페닐나프탈렌-2-보론산을 합성하였다.

[0191] 합성예 4-(2) 화학식 H64의 합성

[0192] 500ml 둥근 바닥 플라스크에 9-브로모-10-(1-나프틸)안트라센 10g(0.026mol), 7-페닐나프탈렌-2-보론산 7.12g(0.029mol), 탄산칼륨(K₂CO₃) 7.21 g(0.052mol), 테트라키스트리페닐포스핀팔라듐 (Pd(PPh₃)₄) 1.51 g, 물 40mL, 톨루엔 100ml 및 테트라하이드로퓨란 100mL를 투입하고 24시간 동안 환류시켰다. 반응이 종결되면, 반응의 결과물을 층 분리하여 수층을 제거하고 유기층을 분리하여 감압농축한 후, 헥산과 디클로로메탄을 전개용매로 사용하여 칼럼크로마토그래피로 분리하여 얻은 고체를 건조한 결과, 6.8 g(수율 51%)의 흰색 고체를 얻었다.

[0193] MS(MALDI-TOF): m/z 506 [M]⁺

[0194] **실시예 : 유기전계발광소자의 제조**

[0195] **실시예 1~4**

[0196] ITO 글래스의 발광면적이 2mm×2mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO 글래스를 진공 챔버에 장착한 후 베이스 압력이 1×10⁻⁷ torr가 되도록 한 후 상기 ITO 위에 CuPc(800 Å), α-NPD(300 Å) 순으로 성막한 후 본 발명에 의한 호스트 화합물 + BD1 화합물 3%를 혼합하여 성막(250Å)한 다음 Alq₃(350 Å), LiF (5 Å), Al (500 Å)의 순서로 성막하여 유기전계발광소자를 제조하였다. 상기 유기전계발광 소자의 발광특성은 0.4mA에서 측정하였다.

[0197] **비교예 1**

[0198] 상기 실시예에 사용된 화합물중 본 발명에 의한 화합물 대신 H73을 사용한 것 이외에는 동일하게 유기전계발광소자를 제작하였으며, 상기 유기전계발광소자의 발광특성은 0.4mA에서 측정하였다. H73의 구조는 다음과 같다.



[0199]

[0200] H73

[0201] 하기 표 1에는 실시예 1~5과 비교예 1에 따라 제조된 유기전계발광소자에 대하여, 전압, 전류, 휘도, 색좌표 및 수명을 측정하고 그 결과를 나타내었다. T80은 휘도가 초기휘도에 비해 80%로 감소되는데 소요되는 시간을 의미한다.

[0202] **[표1]**

구분	호스트	도펀트	V	J (mA/cm ²)	Cd/m ²	CIEx	CIEy	T80
실시예1	H3	BD1	4.22	10	659	0.134	0.127	153
실시예2	H24	BD1	4.11	10	457	0.138	0.122	148
실시예3	H29	BD1	4.18	10	489	0.139	0.120	162
실시예4	H64	BD1	4.33	10	535	0.139	0.124	157
비교예1	H73	BD1	4.82	10	219	0.141	0.125	95

[0204] **실시예 5~9**

- [0221] 50: 유기발광층 60: 전자수송층
- [0222] 70: 전자주입층 80: 캐소드

도면

도면1

80
70
60
50
40
30
20
10

专利名称(译)	主体化合物和使用其的有机电致发光器件		
公开(公告)号	KR1020110076376A	公开(公告)日	2011-07-06
申请号	KR1020090133071	申请日	2009-12-29
[标]申请(专利权)人(译)	SFC股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	에스에프씨주식회사		
当前申请(专利权)人(译)	에스에프씨주식회사		
[标]发明人	JE JONG TAE 제종태 JUNG SUNG OUK 정성욱 KIM SUNG HOON 김성훈 LEE SE JIN 이세진 LEE SANG HAE 이상해		
发明人	제종태 정성욱 김성훈 이세진 이상해		
IPC分类号	C09K11/06 H01L51/50		
CPC分类号	H01L51/006 H01L51/5024 H01L51/5056 H01L51/5072 H01L51/5088 H01L51/5092		
其他公开文献	KR101352438B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

用途：提供主体化合物，以获得可用于显示和亮度的有机电致发光器件，因为它具有优异的亮度，色纯度和寿命特性。组成：主体化合物由化学式(1)表示。在化学式(1)中，na是萘基；A和B独立地选自氢，氘，取代或未取代的C1-20烷基，取代或未取代的C6-40芳基，取代或未取代的C3-20杂芳基，锆基，硼基，取代的或未取代的C1-24烷基甲硅烷基，和取代或未取代的C6-40烷基甲硅烷基；a是0-7的整数；b是1-7的整数；当a和b为2或更大时，多个A和B独立地相同或不同。

80
70
60
50
40
30
20
10